

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ και ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΑ

• Μονόθυροι Αντιστάτες

Γραμμικοί, Μη-γραμμικοί, Χρονικά-μεταβαλλόμενοι
Δίοδοι, Κοίλοι/κυρτοί, Ανεξ. Πηγές
Σύνδεση αντιστατών, Γραφική μέθοδος
Τμηματικά-ευθύγραμμη προσέγγιση
DC ανάλυση (σημεία λειτουργίας)
Ανάλυση αδύνατου σήματος

• Πολύθυροι-Πολυτερματικοί Αντιστάτες

Γραμμικοί, Μη-γραμμικοί, Χρονικά-μεταβαλλόμενοι
Εξαρτημένες πηγές, Γυράτορας, Ιδανικός μετασχηματιστής
Τρανζίστορ
DC ανάλυση
Ανάλυση αδύνατου σήματος

• Τελεστικοί Ενισχυτές

Μοντέλα γραμμικής και μη-γραμμικής λειτουργίας
Εφαρμογές

- Πυκνωτές** (γραμμικοί, μη-γραμμικοί, χρονικά-μεταβαλλόμενοι)
- Επαγωγείς** (γραμμικοί, μη-γραμμικοί, χρονικά-μεταβαλλόμενοι)
- Συζευγμένοι Επαγωγείς** (πραγματικοί μετασχηματιστές)

ΔΙ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ (ΜΟΝΟΘΥΡΟΣ) ΑΝΤΙΣΤΑΤΗΣ [Two-terminal (One-port) Resistor]

ονομάζεται ένα δι-τερματικό στοιχείο του οποίου το **ρεύμα** $i(t)$ και η **τάση** $v(t)$ ικανοποιούν την σχέση ($v - i$ χαρακτηριστική)

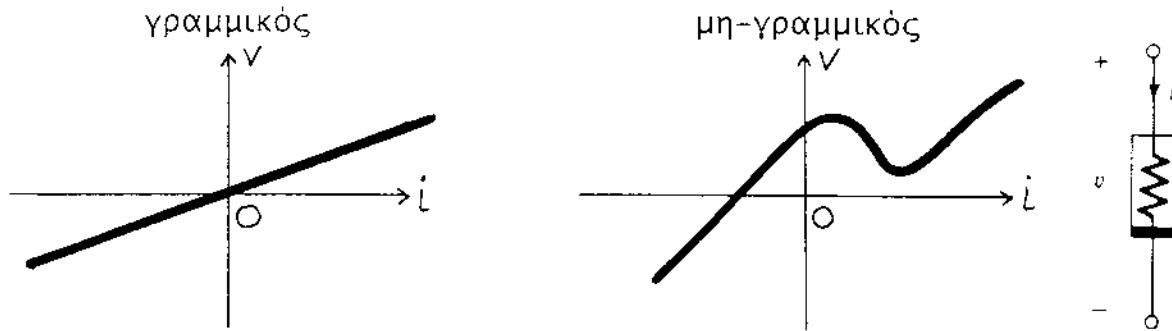
$$\mathcal{R}_{res} = \{(v, i) : f(v, i) = 0\}$$

Χρονικά-Αμετάβλητος $\iff \mathcal{R}$ δεν αλλάζει με τον χρόνο

Χρονικά-Μεταβαλλόμενος $\iff \mathcal{R}$ αλλάζει με τον χρόνο

Γραμμικός $\iff f(v, i) = av + bi$

Μη-γραμμικός $\iff f$ είναι μη-γραμμική συνάρτηση



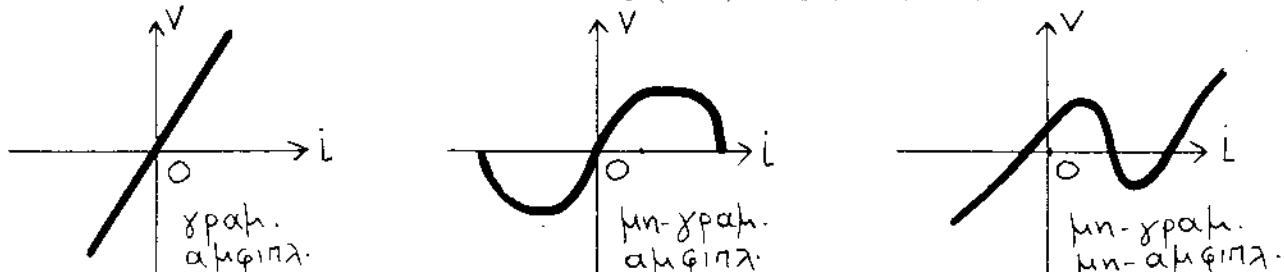
v -ελεγχόμενος (**voltage-controlled**): $f(v, i) = 0 \implies i = \hat{i}(v)$

i -ελεγχόμενος (**current-controlled**): $f(v, i) = 0 \implies v = \hat{v}(i)$

Αφινικός (affine): $\iff f(v, i) = av + bi + c$

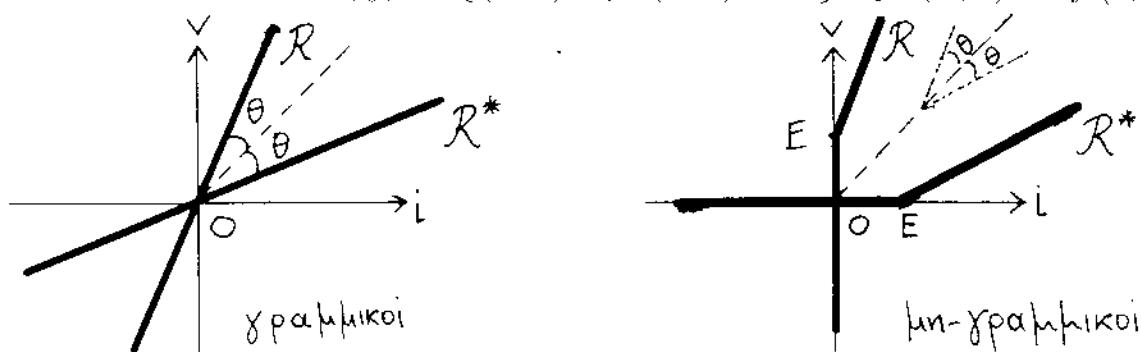
Παθητικός $\iff v(t)i(t) \geq 0 \quad \forall t$. **Ενεργός** = μη-παθητικός.

Αμφιπλευρος (bilateral): $\iff f(v, i) = f(-v, -i)$



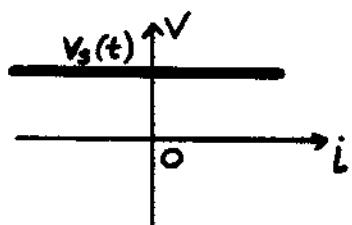
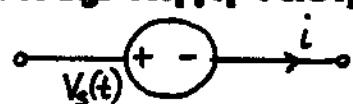
Δυαδικός (dual) του \mathcal{R} είναι ο αντιστάτης που έχει ως $v - i$ χαρακτηριστική:

$\mathcal{R}_{res}^* = \{(v, i) : f^*(v, i) = 0\}, \quad f^*(v, i) = f(i, v)$

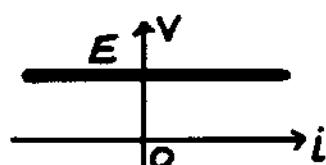
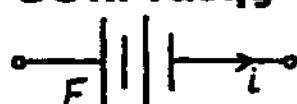


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

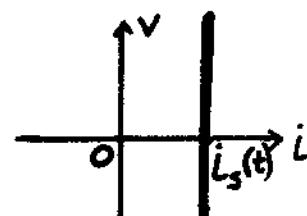
Ανεξ. Πηγή Τάσης



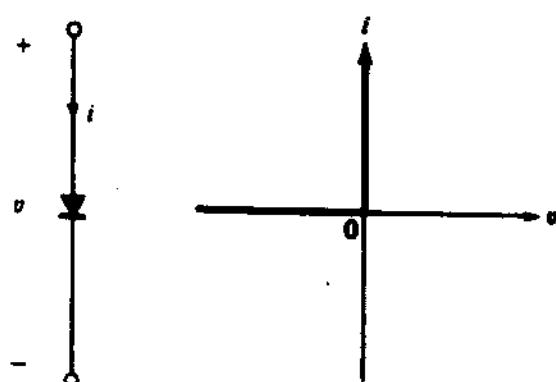
DC Π. Τάσης



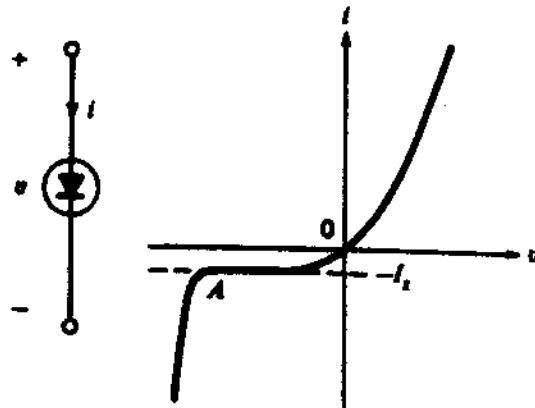
Π. Ρεύματος



Ιδανική Δίοδος

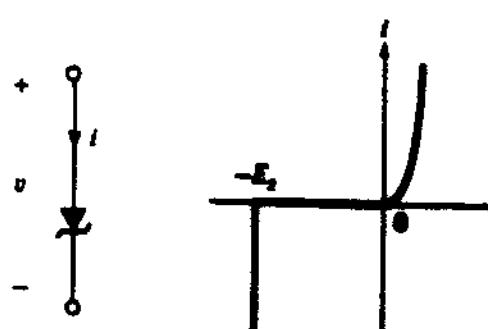


Δίοδος Ενώσης (pn-junction)

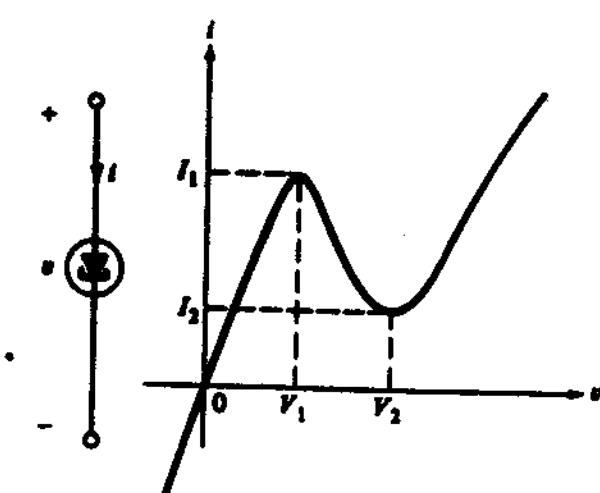


$$i = I_S \left[\exp\left(\frac{v}{V_T}\right) - 1 \right]$$

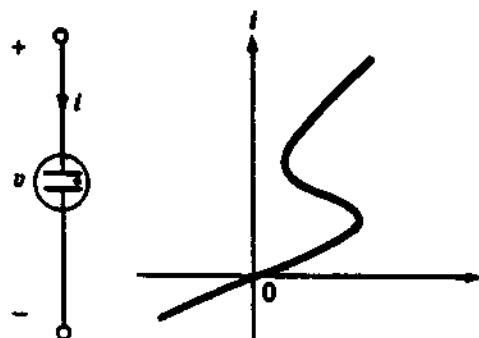
Δίοδος Zener



Δίοδος Tunnel



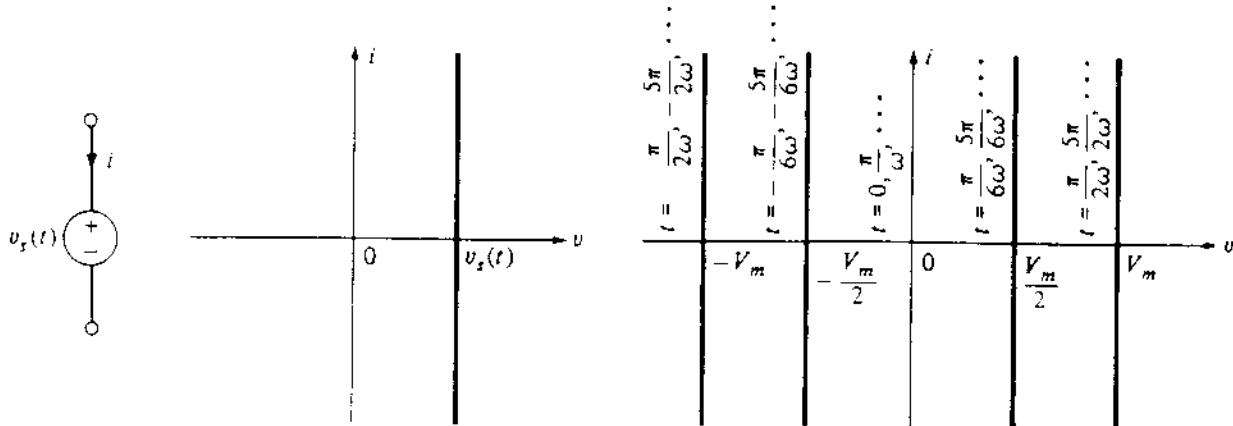
Glow Tube



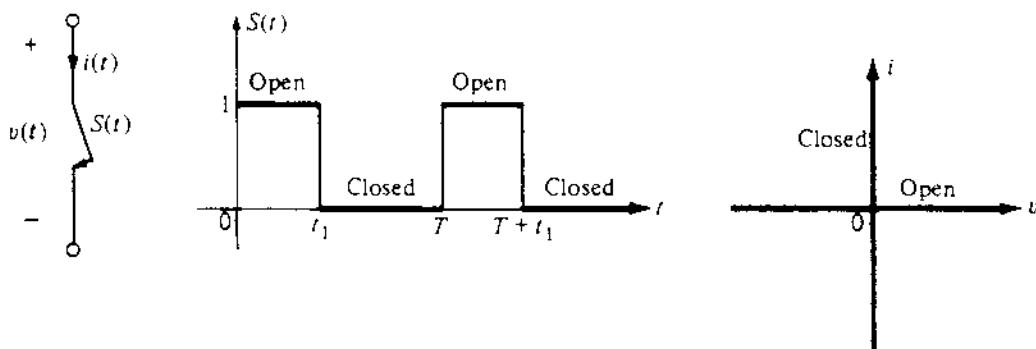
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΑ-ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

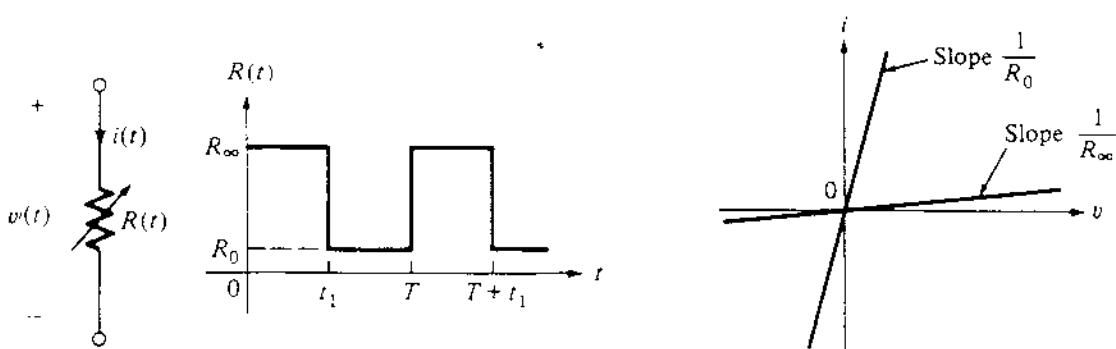
AC Πηγή Τάσης: $v(t) = v_s(t) = V_m \sin(\omega t) \quad \forall i(t)$



Περιοδικός Διακόπτης



Χρονικά-Μεταβαλλόμενος Γραμμικός Αντιστάτης: $v(t) = R(t)i(t)$

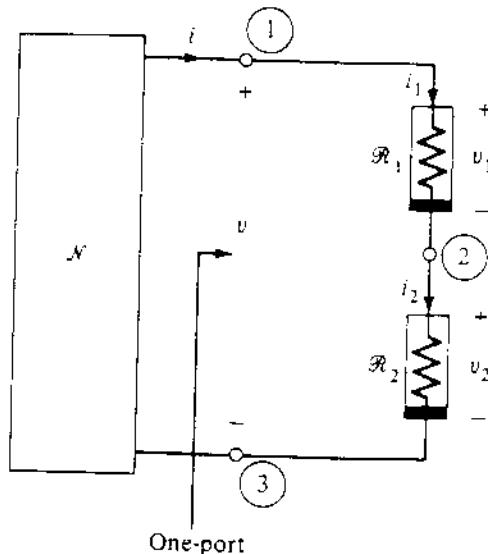


ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΟΘΥΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

Σειριακή: εάν όλοι οι αντιστάτες είναι i -ελεγχόμενοι, η $v - i$ χαρακτηριστική του μονόθυρου σύνδεσης ευρίσκεται αναλυτικά.
(Αλλοιώς, γραφικά.)

$$v_1 = \hat{v}_1(i_1), \quad v_2 = \hat{v}_2(i_2)$$

$$v = \hat{v}(i) = \hat{v}_1(i) + \hat{v}_2(i)$$

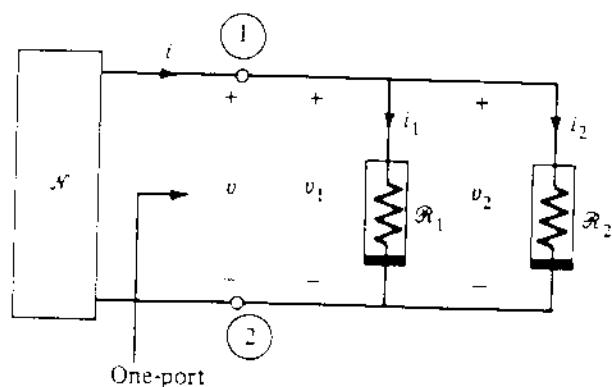


Παράλληλη: εάν όλοι οι αντιστάτες είναι v -ελεγχόμενοι, η $v - i$ χαρακτηριστική του μονόθυρου σύνδεσης ευρίσκεται αναλυτικά.

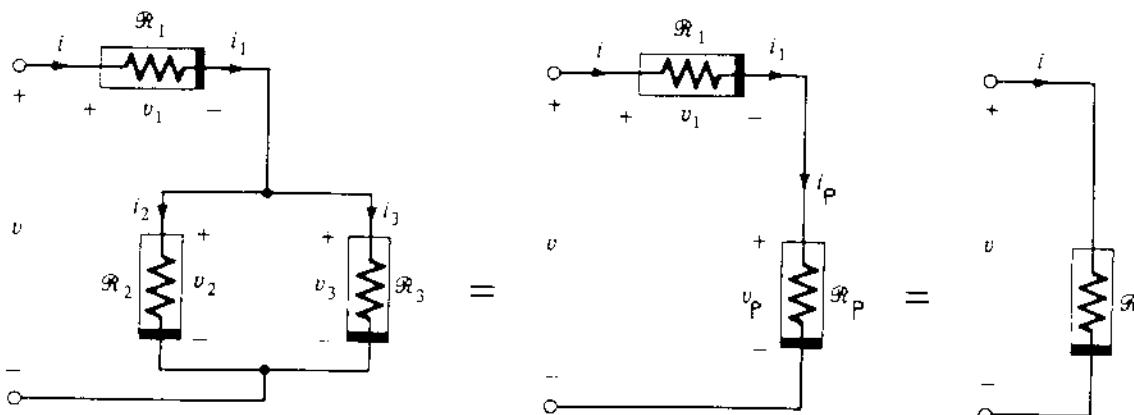
(Αλλοιώς, γραφικά.)

$$i_1 = \hat{i}_1(v_1), \quad i_2 = \hat{i}_2(v_2)$$

$$i = \hat{i}(v) = \hat{i}_1(v) + \hat{i}_2(v)$$

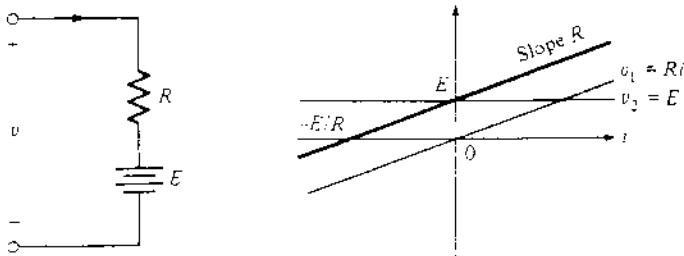


Σειριακή-Παράλληλη: εάν οι σειριακοί αντιστάτες είναι i -ελεγχόμενοι & οι παράλληλοι αντιστάτες είναι v -ελεγχόμενοι:
 $v_1 = \hat{v}_1(i_1)$, $i_p = g(v_p) = \hat{i}_2(v_2) + \hat{i}_3(v_3)$. Εάν υπάρχει η g^{-1}
 $\Rightarrow v = \hat{v}(i) = \hat{v}_1(i) + g^{-1}(i)$

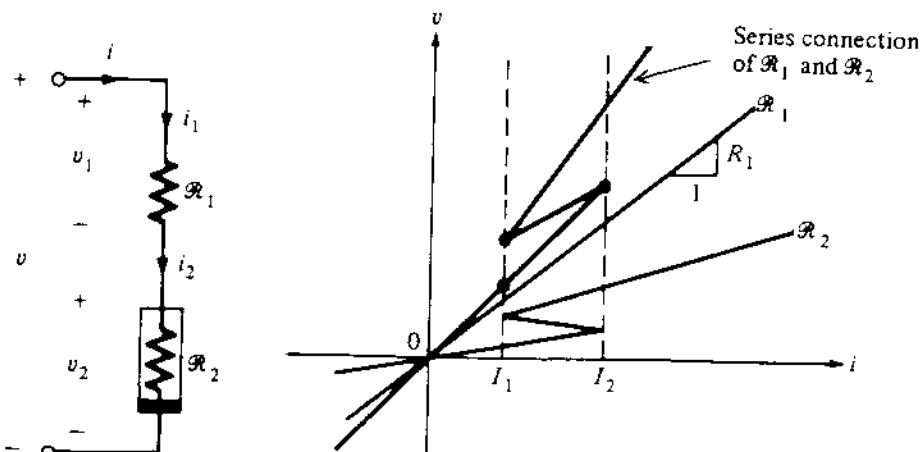


Παραδείγματα Ευρεσης της $v - i$ Χαρακτηριστικής της Σύνδεσης Αντιστάτων με την Γραφική Μέθοδο

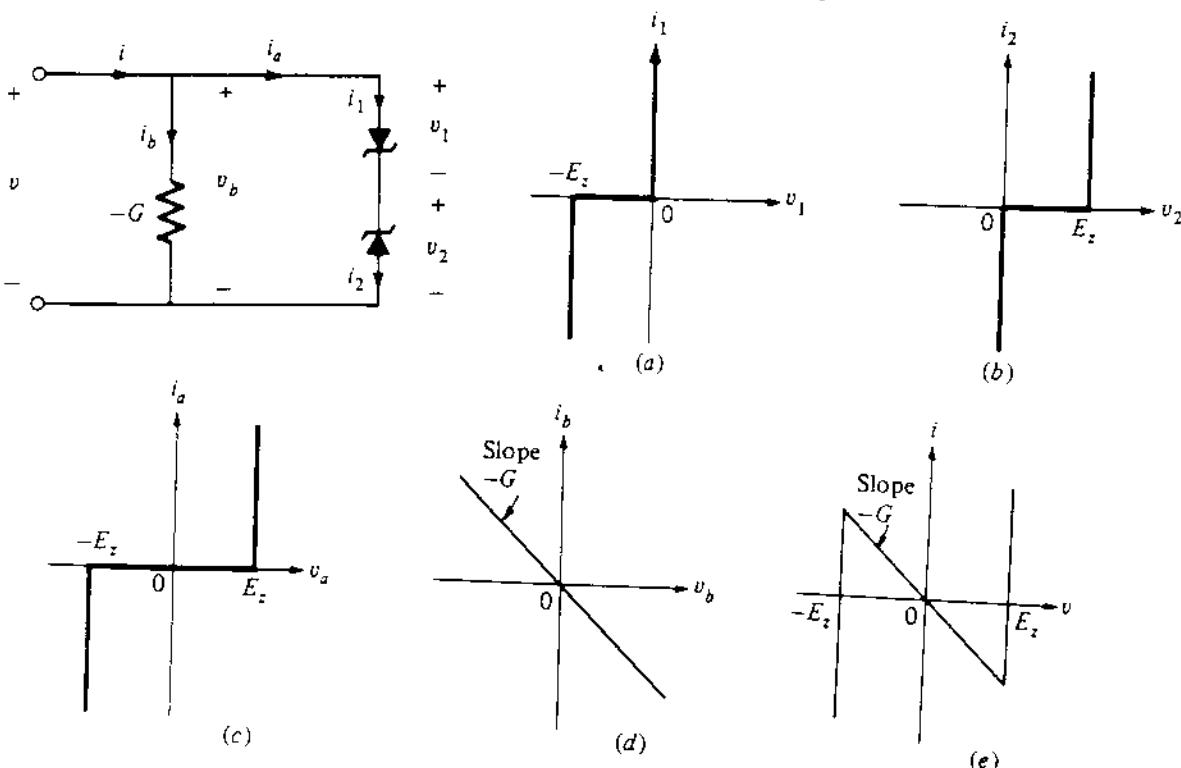
Μοντέλο μπαταρίας (αφινικός αντιστάτης): $v = Ri + E$



Σειριακή σύνδεση γραμμικού και i -ελεγχόμενου αντιστάτη



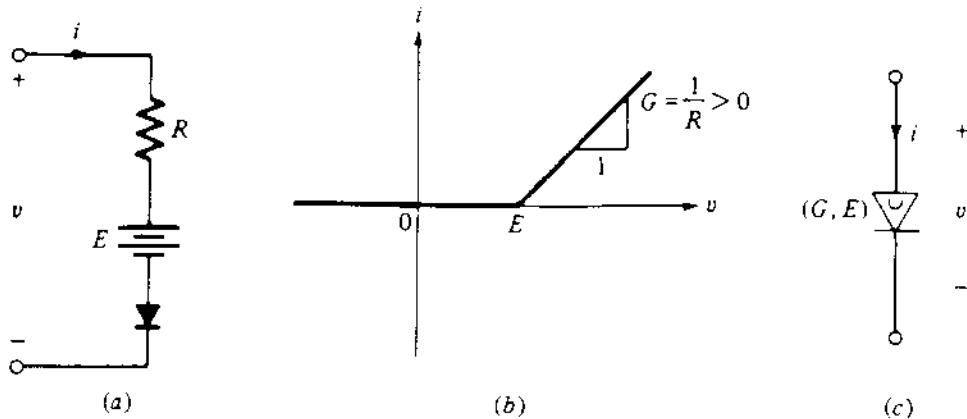
Σειριακό-παράλληλο κύκλωμα με διόδους Zener



(a) Piecewise-linear characteristic of a zener diode. (b) Characteristic of a zener diode with its two terminals turned around. (c) characteristic of the series connection of the two. (d) characteristic of the linear resistor, and (e) the resulting driving-point characteristic of the one-port.

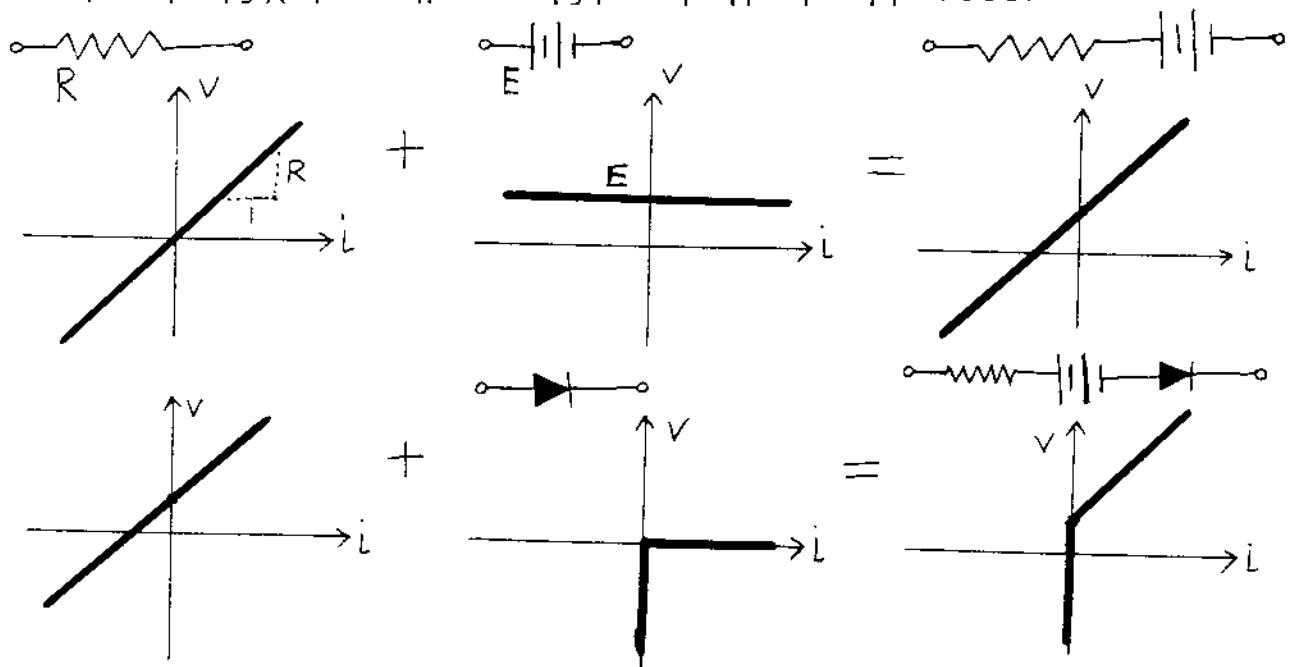
ΚΟΙΛΟΙ κατ ΚΥΡΤΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ

Κοιλος (concave) αντιστάτης: $i = G[|v - E| + (v - E)]/2$

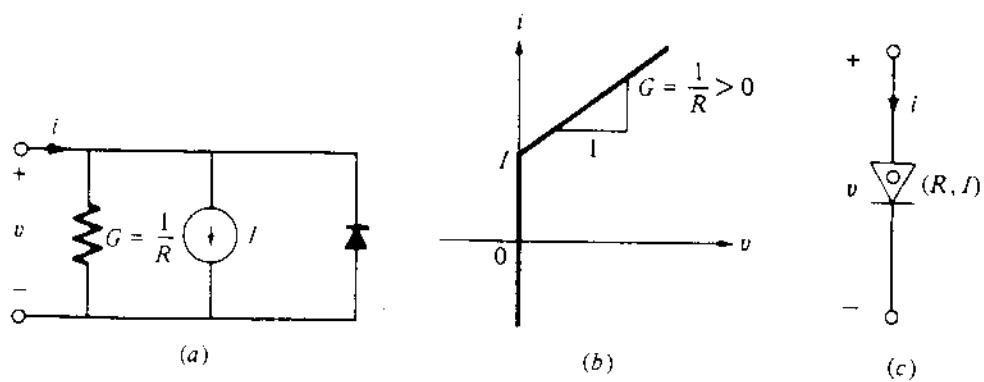


(a) Equivalent circuit, (b) characteristic, and (c) symbol for a concave resistor.

Εύρεση της χαρακτηριστικής με την γραφική μέθοδο:



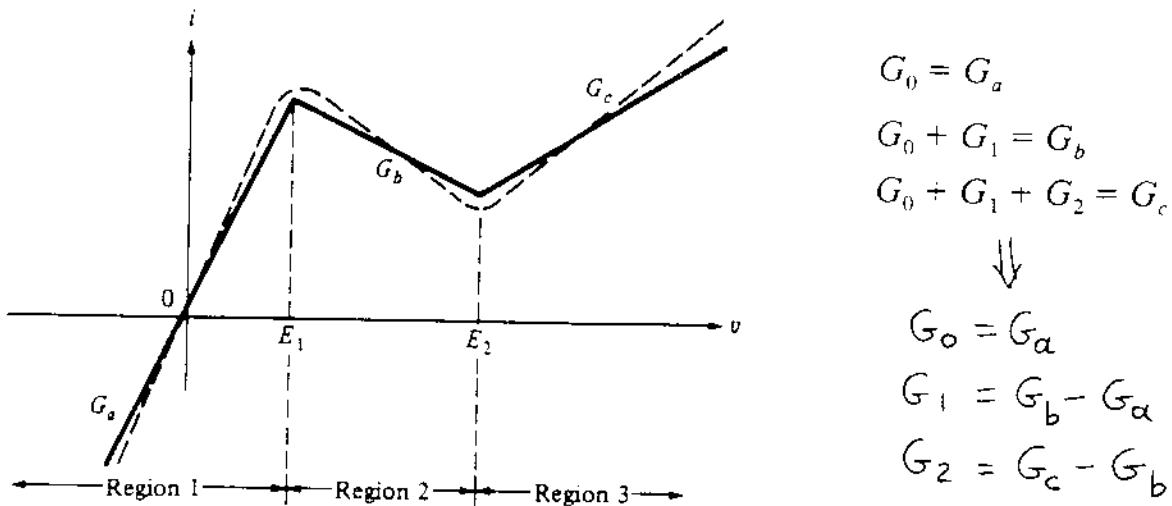
Κυρτός (convex) αντιστάτης: $v = R[|i - I| + (i - I)]/2$



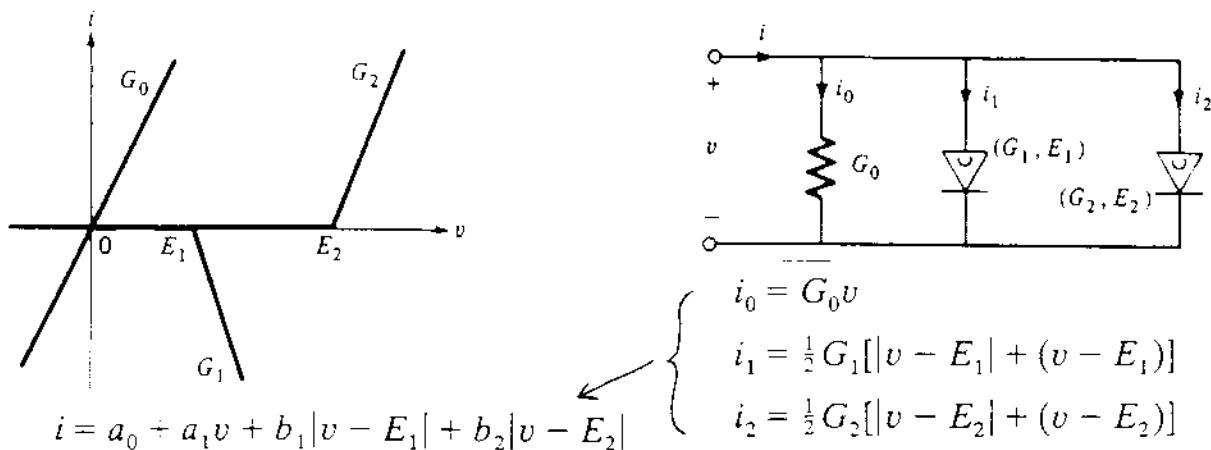
(a) Equivalent circuit, (b) characteristic, and (c) symbol for a convex resistor.

ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ-ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (Piecewise-Linear Approximation)

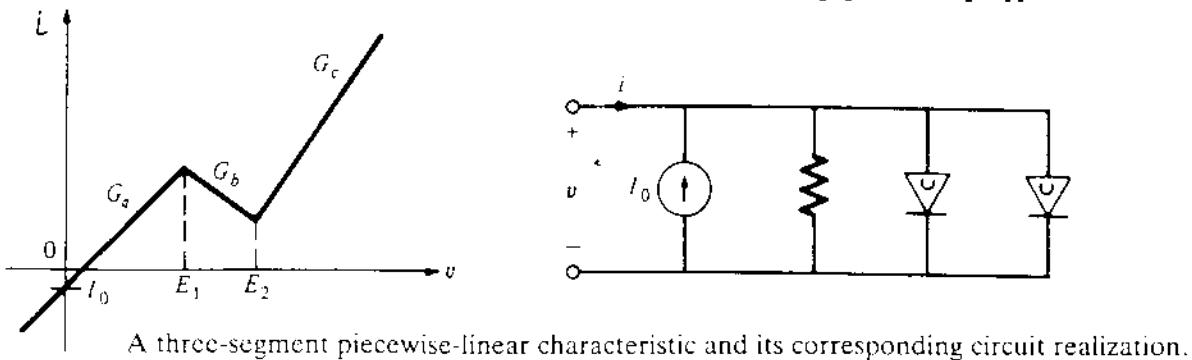
Τμημ.-ευθ. προσέγγ. χαρακτηριστικής $v - i$ διόδου Tunnel



Σύνθεση της τμημ.-ευθ. χαρακτηριστικής από 3 συστατικά



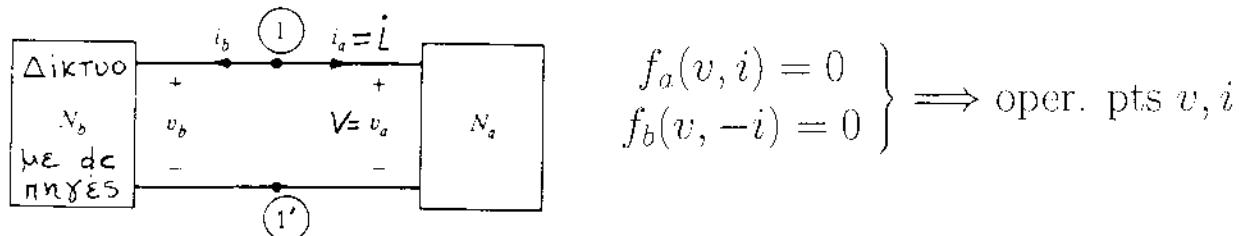
Γενική τμηματ.-ευθύγραμ. μοντελοποίηση με 3 τμήματα



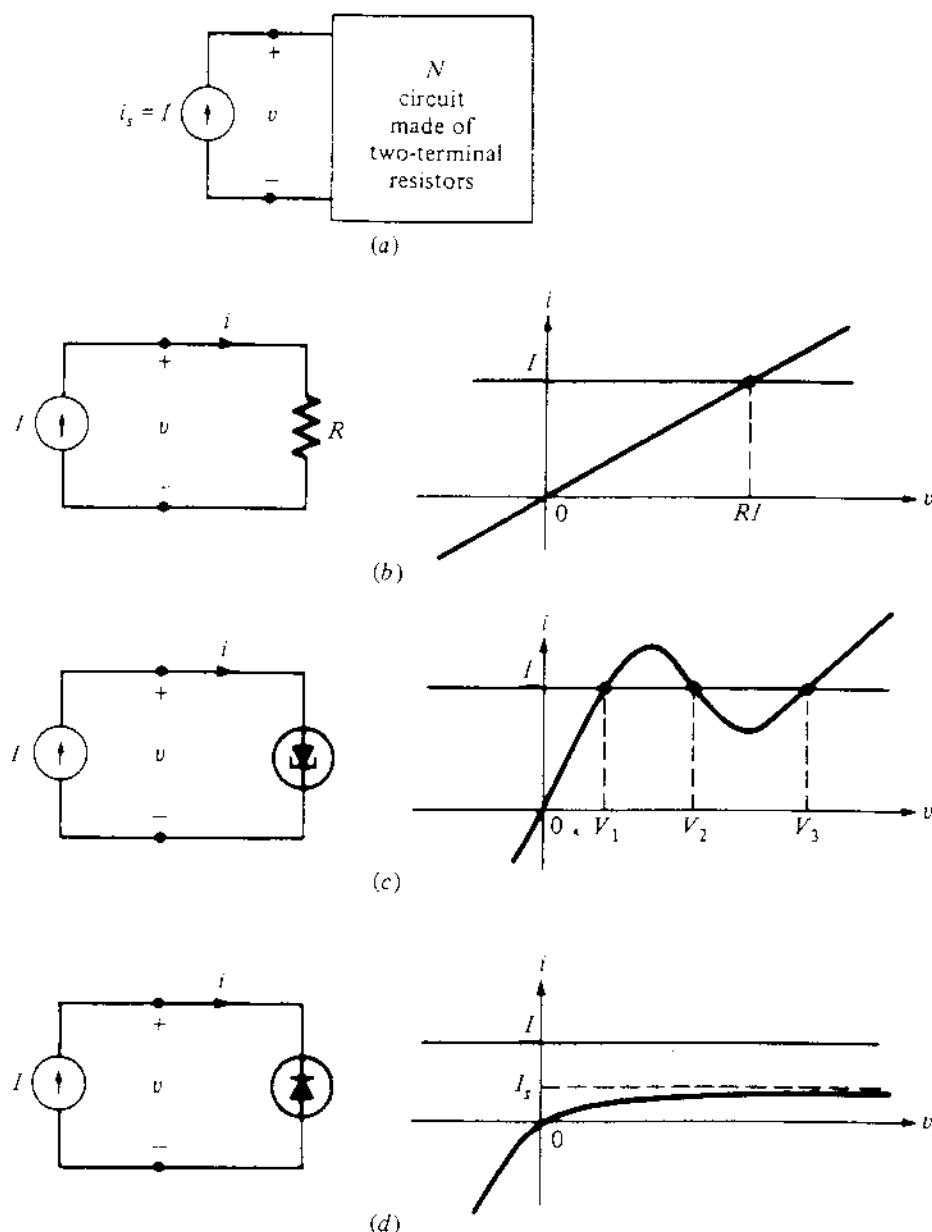
Γενική μοντελοποίηση με n τμήματα: Κάθε v -ελεγχόμενη (i -ελεγχόμενη) τμημ.-ευθ. χαρακτηριστική μπορεί να μοντελοποιηθεί ακριβώς με παράλληλη (σειριακή) σύνδεση πηγής ρεύματος (τάσης), γραμμικής αντίστασης, και $n - 1$ κοίλων (κυρτών) αντιστάσεων.

DC ΑΝΑΛΥΣΗ

Εύρεση των σημείων λειτουργίας (operating points), δηλ. των λύσεων (v, i) , του κυκλώματος με dc εισόδους.



Μέθοδοι: αναλυτική, γραφική, αριθμητική, τμηματικά-ευθύγραμμη

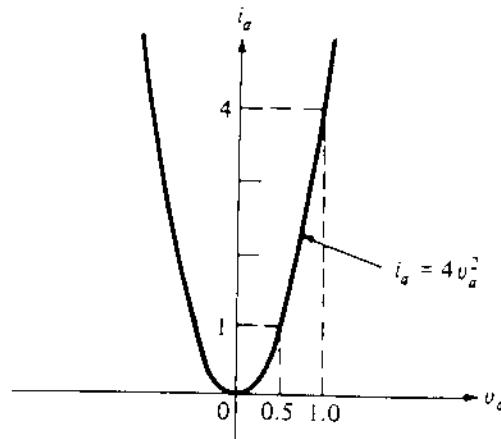
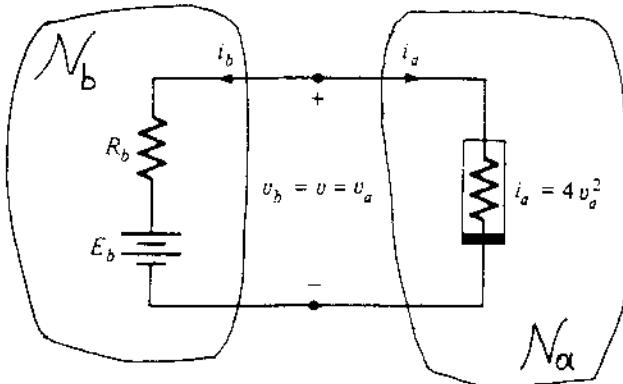


(a) A one-port N driven by a dc source. (b) With a linear resistor in N , there exists a unique solution. (c) With a tunnel-diode characteristic, the circuit has three solutions. (d) With a $p-n$ -junction-diode characteristic, the circuit has no solution if $I > I_s$.

DC ΑΝΑΛΥΣΗ (αναλυτική, αριθμητική, γραφική)

$$f_a(v_a, i_a) = i_a - 4v_a^2 = 0$$

$$f_b(v_b, i_b) = v_b - E_b - R_b i_b = 0$$



Αναλυτική μέθοδος: επίλυση των $f_a(v, i) = 0$ και $f_b(v, -i) = 0$

$$\begin{aligned} i &= 4v^2 \\ v = E_b - R_b i &\implies \underbrace{4R_b v^2 + v - E_b}_{f(v)} = 0 \end{aligned}$$

$E_b = 2\text{V}$ $R_b = 0.25\Omega$ $(v_1 = 1, i_1 = 4)$
 $v_2 = -2, i_2 = 16)$

Αριθμητική μέθοδος: επίλυση της $f(x) = 0$ με **Newton-Raphson**

αρχική εκτίμηση: x_0 (κοντά σε μια λύση x^*)

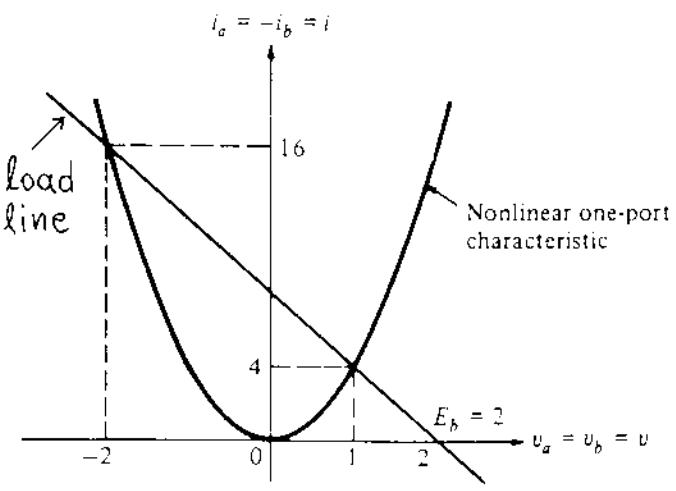
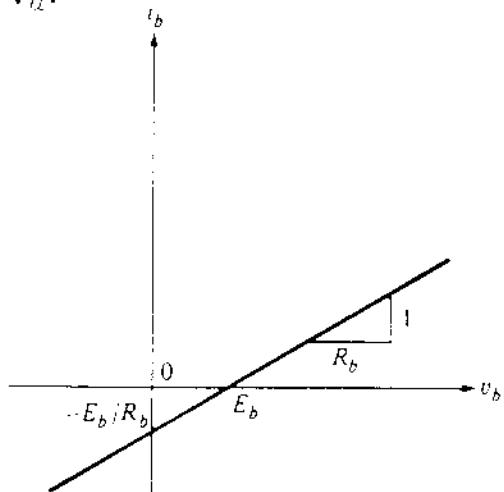
επανάληψη: $x_{n+1} = x_n - [f(x_{n-1})/f'(x_{n-1})]$, $n = 1, 2, 3, \dots$

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$, $f(x^*) = 0$.

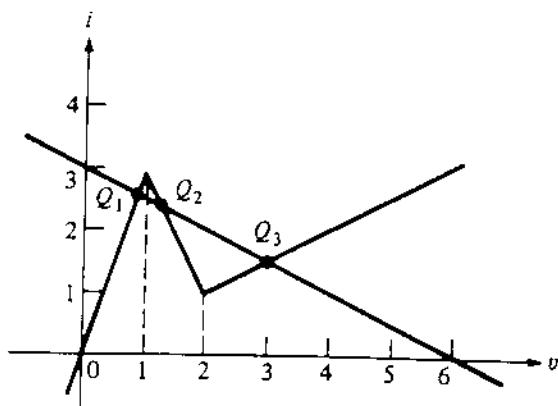
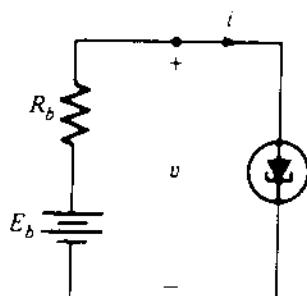
Παράδειγμα του κυκλώματος: $f(x) = x^2 + x - 2$

$x_0 = 0 \implies x_1 = 2$, $x_2 = 1.2$, $x_3 = 1.012$, $x_4 = x^* = 1$ (η μία λύση v)

Γραφική μέθοδος: Μεταγραφή της χαρακτηριστικής $v_b - i_b$ στο επίπεδο $v_a - i_a$. DC σημεία λειτουργίας είναι τα σημεία τομής της γραμμής φορτίου (load line) με την χαρακτηριστική του μονόθυρου \mathcal{N}_a .



DC ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ-ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ



Τμημ.-ευθύγρ. προσέγγιση χαρακτηριστικής διόδου Tunnel

$$i = a_0 + a_1 v + b_1 |v - E_1| + b_2 |v - E_2|$$

$$a_0 = -0.5, a_1 = 2, b_1 = -2.5, b_2 = 1.5, E_1 = 1, E_2 = 2$$

Αναλυτική εύρεση σημείων λειτουργίας $Q = (V_Q, I_Q)$

$$\left. \begin{array}{l} \text{περιοχή 1} (v \leq E_1) : \quad i = a_0 + a_1 v - b_1(v - E_1) - b_2(v - E_2) \\ \text{περιοχή 2} (E_1 < v \leq E_2) : \quad i = a_0 + a_1 v + b_1(v - E_1) - b_2(v - E_2) \\ \text{περιοχή 3} (E_2 < v) : \quad i = a_0 + a_1 v + b_1(v - E_1) + b_2(v - E_2) \\ \text{γραμμή φορτίου:} \quad v = E_b - R_b i \\ \text{έλεγχος εγκυρότητας λύσεων} \end{array} \right\} \Rightarrow Q$$

Γραμμή φορτίου 1: $E_b = 6, R_b = 2 \Rightarrow 3$ σημεία Q_1, Q_2, Q_3

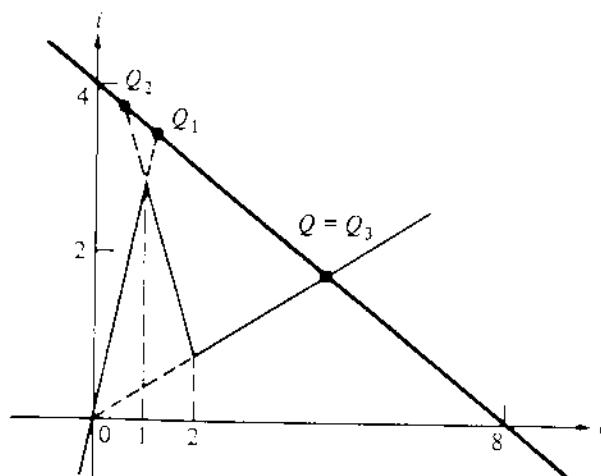
$$Q = (V_Q, I_Q); \quad Q_1 = (\frac{6}{7}, \frac{18}{7}), \quad Q_2 = (\frac{4}{3}, \frac{7}{3}), \quad Q_3 = (\frac{8}{3}, \frac{5}{3}).$$

V_{Q1}, V_{Q2}, V_{Q3} : έγκυρες $\Rightarrow Q_1, Q_2, Q_3$: έγκυρα

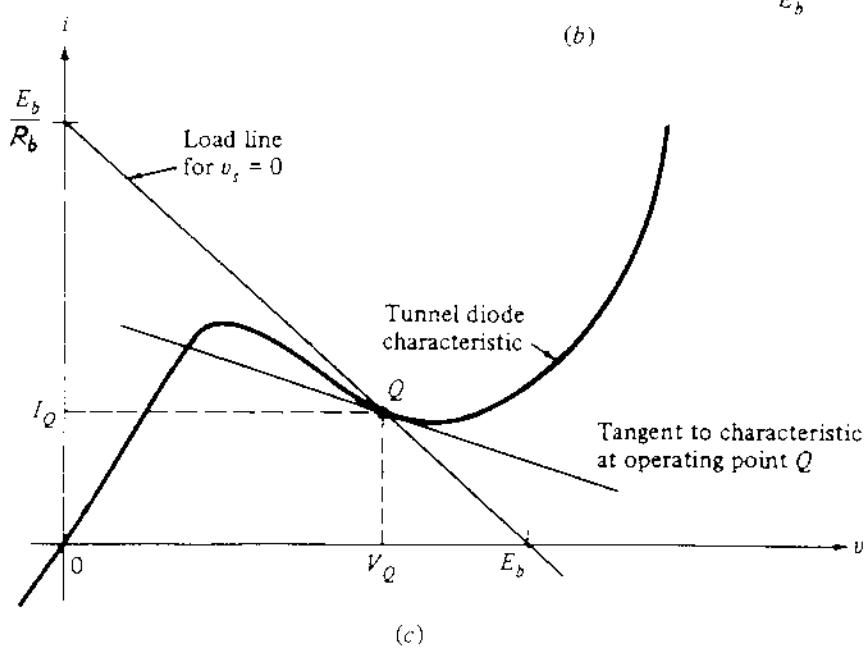
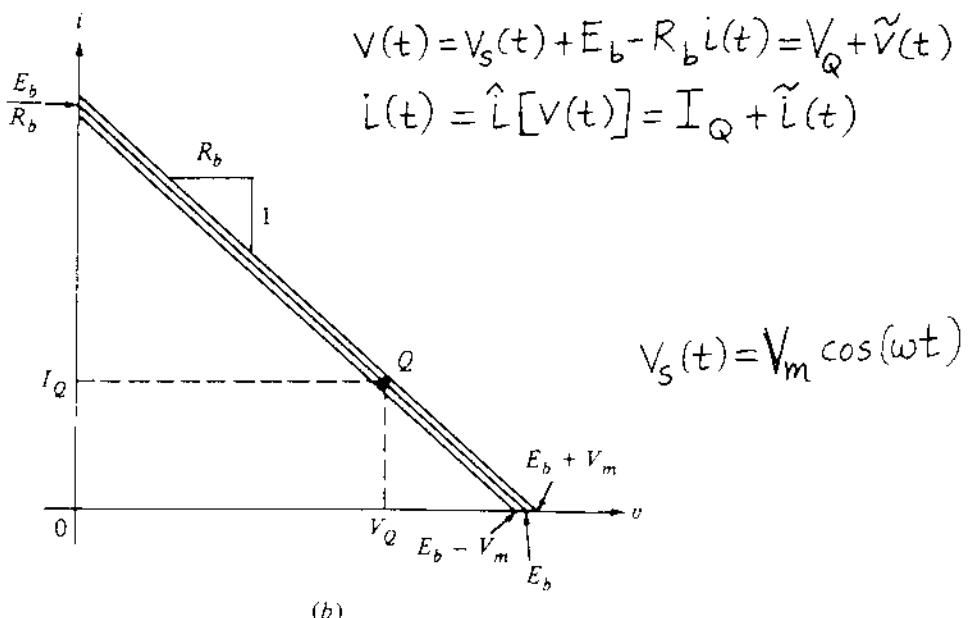
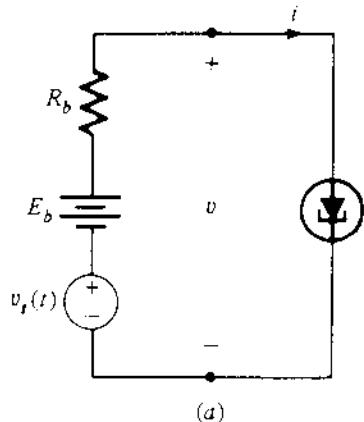
Γραμμή φορτίου 2: $E_b = 8, R_b = 2 \Rightarrow 1$ σημείο Q_3

$$V_{Q1} = \frac{8}{7}, \quad V_{Q2} = \frac{2}{3}; \quad \text{μη-έγκυρες} \Rightarrow Q_1, Q_2: \text{μη-έγκυρα}$$

$$V_{Q3} = \frac{10}{3}; \quad \text{έγκυρη} \Rightarrow Q_3 = (\frac{10}{3}, \frac{7}{3}); \quad \text{έγκυρο}$$



ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (Small-Signal Analysis)

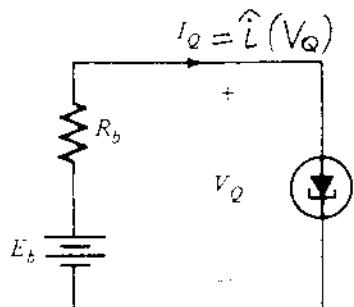


(a) Tunnel-diode circuit with signal source $v_s(t)$, (b) moving load line, and (c) linear approximation to the diode characteristic at the operating point Q .

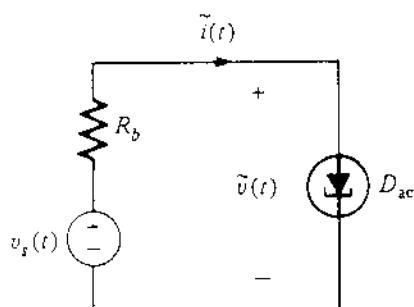
$$V_m \ll E_b$$

Ανάπτυξη εε σειρά Taylor} $\Rightarrow i(t) = I_Q + \tilde{i}(t) = \tilde{i}[V_Q + \tilde{v}(t)] \approx \tilde{i}[V_Q] + \frac{d\tilde{i}}{dv} \Big|_{V_Q} \tilde{v}(t)$
γύρω από το σημείο Q

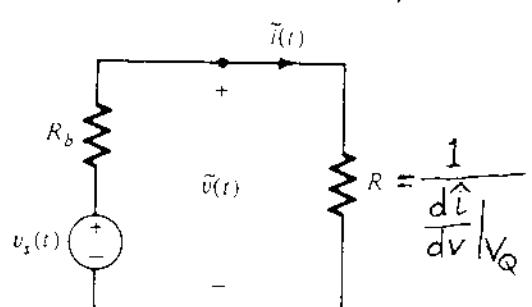
DC Ιεοδύν. κύκλωμα



AC Ιεοδύναμο



Ιεοδύναμο Μικρού Σήματος



$$V_Q = E_b - R_b I_Q$$

$D_{ac} = \delta \text{ιοδος με χαρακτηριστικη μετατοπισμενη στο } Q.$

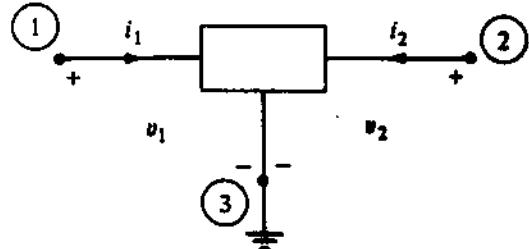
$$V_s(t) = \tilde{V}(t) + R_b \tilde{i}(t)$$

ΤΡΙ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ή ΔΙΘΥΡΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗΣ

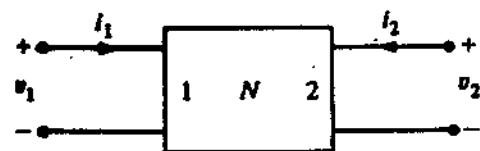
ονομάζεται ένα τρι-τερματικό ή δίθυρο στοιχείο εάν τα ρεύματα και οι τάσεις θυρών ικανοποιούν την σχέση ($v - i$ χαρακτηριστική)

$$\mathcal{R}_{res} = \{(v_1, v_2, i_1, i_2) : f_1(v_1, v_2, i_1, i_2) = 0, f_2(v_1, v_2, i_1, i_2) = 0\}$$

Χρονικά (μη) μεταβαλλόμενος $\iff \mathcal{R}$ (δεν) αλλάζει με τον χρόνο



Three-terminal element with node ③ chosen as the datum node.



A two-port with its port voltage v_1, v_2 and port currents i_1, i_2 .

Γραμμικός $\iff f_k(v_1, v_2, i_1, i_2) = a_k v_1 + b_k v_2 + c_k i_1 + d_k i_2, k = 1, 2$

Representations	Scalar equations	Vector equations
Current-controlled	$v_1 = r_{11}i_1 + r_{12}i_2$ $v_2 = r_{21}i_1 + r_{22}i_2$	$\mathbf{v} = \mathbf{R}\mathbf{i}$
Voltage-controlled	$i_1 = g_{11}v_1 + g_{12}v_2$ $i_2 = g_{21}v_1 + g_{22}v_2$	$\mathbf{i} = \mathbf{G}\mathbf{v}$
Hybrid 1	$v_1 = h_{11}i_1 + h_{12}v_2$ $i_2 = h_{21}i_1 + h_{22}v_2$	$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \mathbf{H} \begin{bmatrix} i_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$
Hybrid 2	$i_1 = h'_{11}v_1 + h'_{12}i_2$ $v_2 = h'_{21}v_1 + h'_{22}i_2$	$\begin{bmatrix} i_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \mathbf{H}' \begin{bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$
Transmission 1†	$v_1 = t_{11}v_2 - t_{12}i_2$ $i_1 = t_{21}v_2 - t_{22}i_2$	$\begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \mathbf{T} \begin{bmatrix} v_2 \\ -i_2 \end{bmatrix}$
Transmission 2†	$v_2 = t'_{11}v_1 + t'_{12}i_1$ $-i_2 = t'_{21}v_1 + t'_{22}i_1$	$\begin{bmatrix} v_2 \\ -i_2 \end{bmatrix} = \mathbf{T}' \begin{bmatrix} v_1 \\ i_1 \end{bmatrix}$

Μη-γραμμικός $\iff f_1$ ή f_2 είναι μη-γραμμική

Current-controlled representation	Voltage-controlled representation
$v_1 = \hat{v}_1(i_1, i_2)$	$i_1 = \hat{i}_1(v_1, v_2)$
$v_2 = \hat{v}_2(i_1, i_2)$	$i_2 = \hat{i}_2(v_1, v_2)$
Hybrid 1 representation	Hybrid 2 representation
$v_1 = \hat{v}_1(i_1, v_2)$	$i_1 = \hat{i}_1(v_1, i_2)$
$i_2 = \hat{i}_2(i_1, v_2)$	$v_2 = \hat{v}_2(v_1, i_2)$
Transmission 1 representation	Transmission 2 representation
$v_1 = \hat{v}_1(v_2, -i_2)$	$v_2 = \hat{v}_2(v_1, i_1)$
$i_1 = \hat{i}_1(v_2, -i_2)$	$-i_2 = \hat{i}_2(v_1, i_1)$

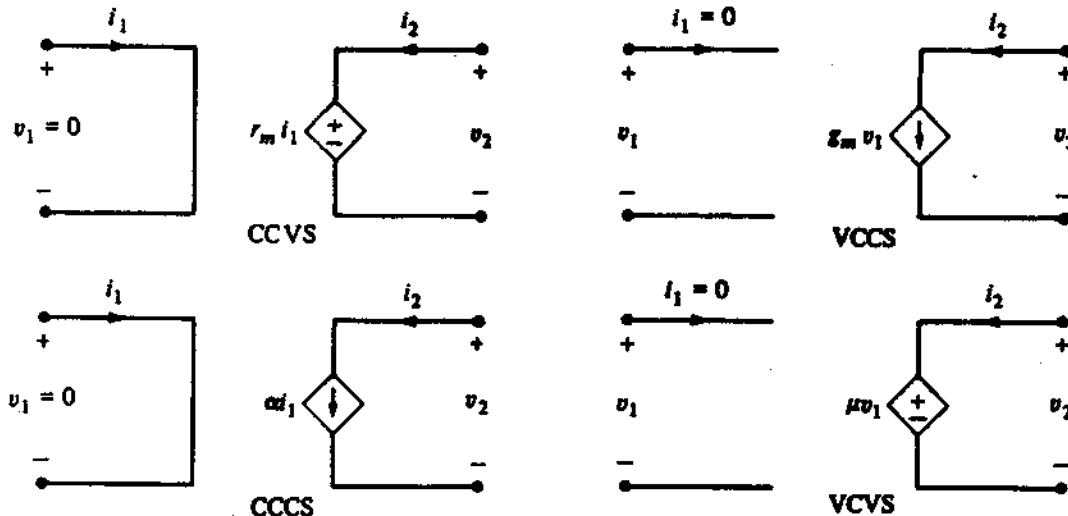
ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ

CCVS (Current-Controlled Voltage Source): i -ελεγχόμενη Πηγή Τάσης

VCCS (Voltage-Controlled Current Source): v -ελεγχόμενη Πηγή Ρεύματος

CCCS (Current-Controlled Current Source): i -ελεγχόμενη Πηγή Ρεύματος

VCVS (Voltage-Controlled Voltage Source): v -ελεγχόμενη Πηγή Τάσης



$$\text{CCVS:} \quad v_1 = 0 \quad v_2 = r_m i_1$$

$$\text{VCCS:} \quad i_1 = 0 \quad i_2 = g_m v_1$$

$$\text{CCCS:} \quad v_1 = 0 \quad i_2 = \alpha i_1$$

$$\text{VCVS:} \quad i_1 = 0 \quad v_2 = \mu v_1$$

$$\text{CCVS:} \quad \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ r_m & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

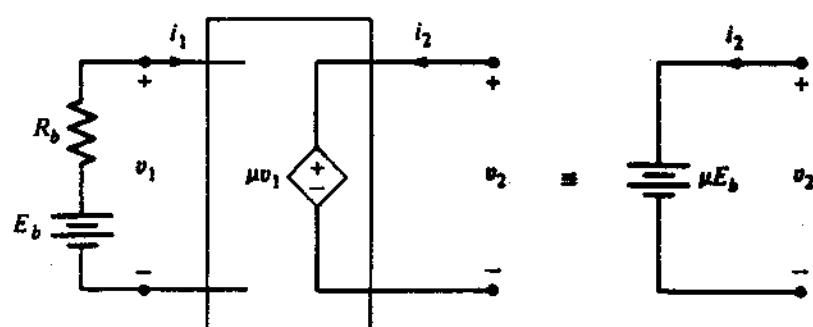
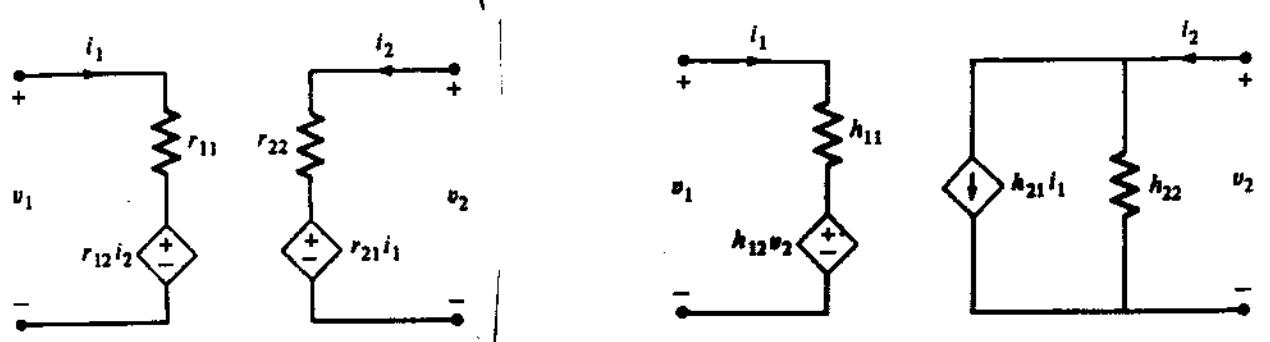
$$\text{VCCS:} \quad \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ g_m & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{CCCS:} \quad \begin{bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \alpha & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

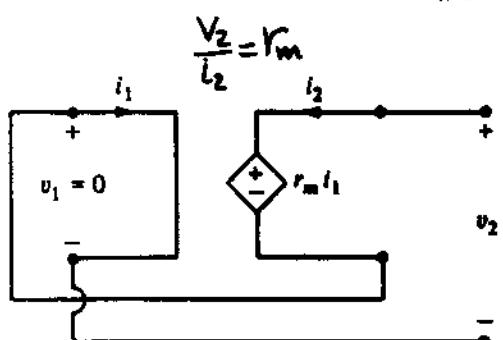
$$\text{VCVS:} \quad \begin{bmatrix} i_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \mu & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ

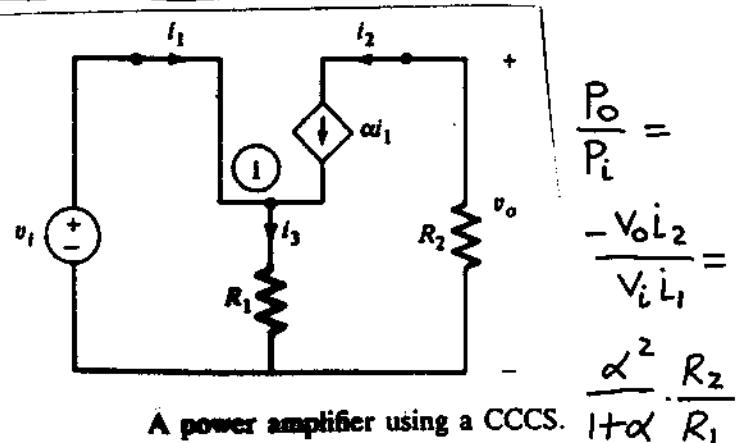
- Μοντελοποιηση Διδυρων αντιστατων



A VCVS connected at the primary side by a battery with internal resistance R_b functions as an independent dc voltage source.

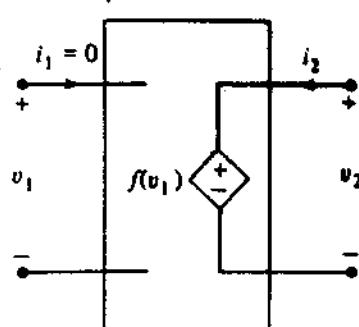


The CCVS functions as a linear resistor.

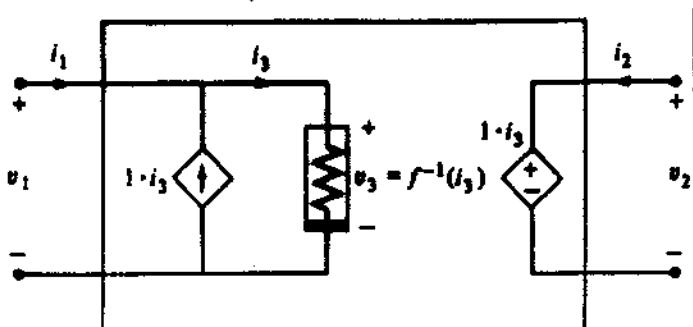


A power amplifier using a CCCS.

Mn-γραμμική VCVS



Ισοδύναμο κύκλωμα και γραμμικές εξαρτημένες πηγές



Παραδείγματα Γραμμικών Πολυτερματικών Αντιστατών

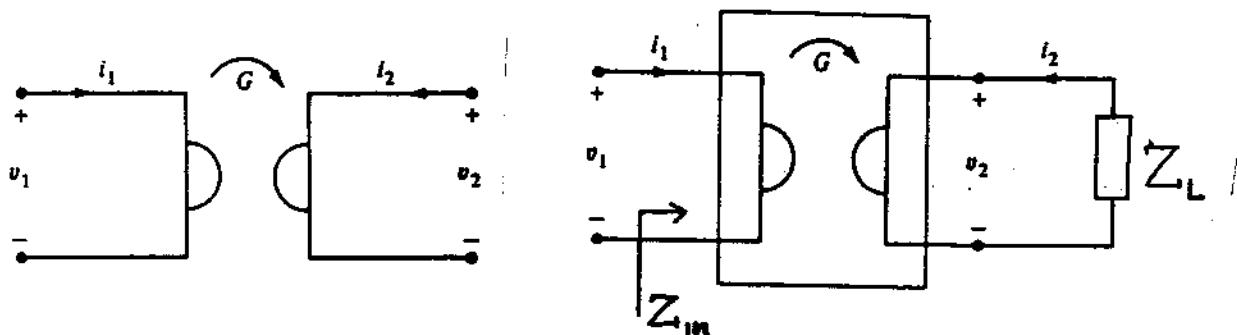
μη-ενεργικά στοιχεία: $\text{power}(t) = \sum_k v_k(t)i_k(t) = 0 \forall t$

- **Γυράτορας** (gyrator): $\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & G \\ -G & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$

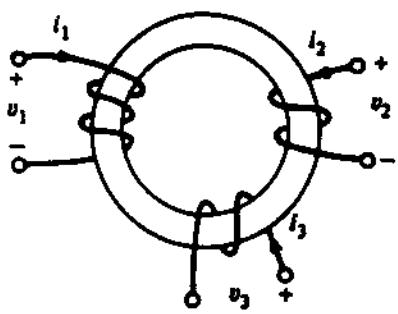
$Z_L = i$ -ελεγχόμενος αντιστάτης με $v_2 = f(-i_2)$ & $G = 1 \Rightarrow$

$Z_{in} = \text{δυαδικός } v\text{-ελεγχόμενος αντιστάτης με } i_1 = f(v_1)$

$Z_L = \text{χωρητικότητα} \Rightarrow Z_{in} = \text{επαγγή}$

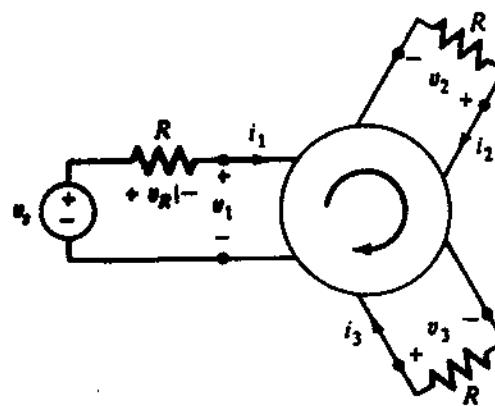
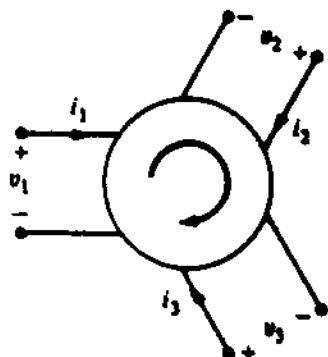


- **Τρίθυρος Ιδανικός Μετασχηματιστής**



$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{n_1}{n_3} \\ 0 & 0 & \frac{n_2}{n_3} \\ -\frac{n_1}{n_3} & -\frac{n_2}{n_3} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$$

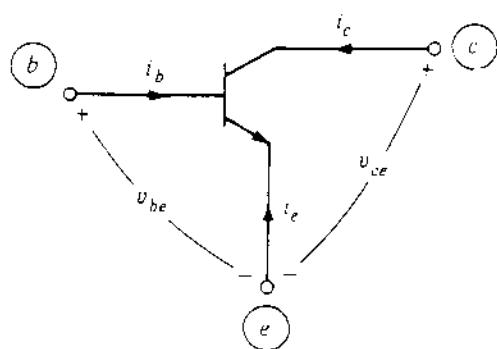
- **Κυκλοφορητής** (circulator)



$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & R & -R \\ -R & 0 & R \\ R & -R & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix}$$

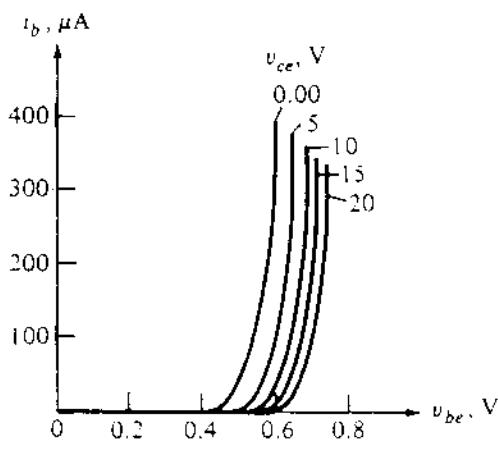
ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΝΩΣΗΣ (ηρη Bipolar Transistor)

Συνδεσμολογία Κοινού Εκπομπού

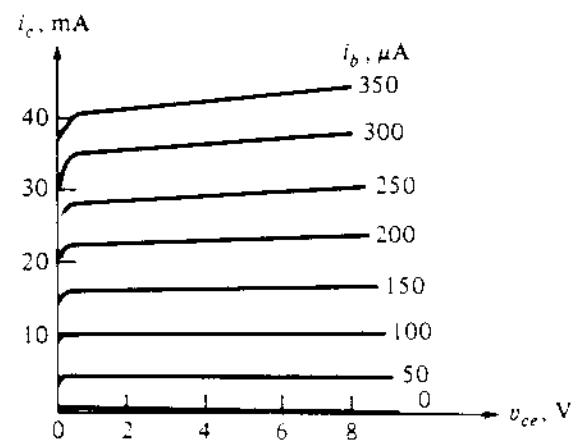


$$i_b = (1 - \alpha_F)I_{ES} \left(\exp \frac{v_{be}}{V_T} - 1 \right) + (1 - \alpha_R)I_{CS} \left(\exp \frac{v_{be} - v_{ce}}{V_T} - 1 \right)$$

$$i_c = \alpha_F I_{ES} \left(\exp \frac{v_{be}}{V_T} - 1 \right) - I_{CS} \left(\exp \frac{v_{be} - v_{ce}}{V_T} - 1 \right)$$

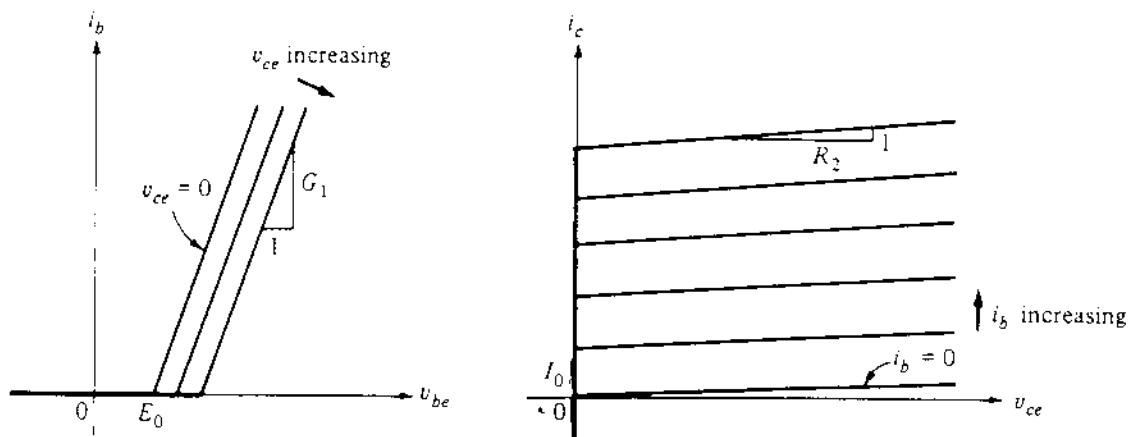


(a)

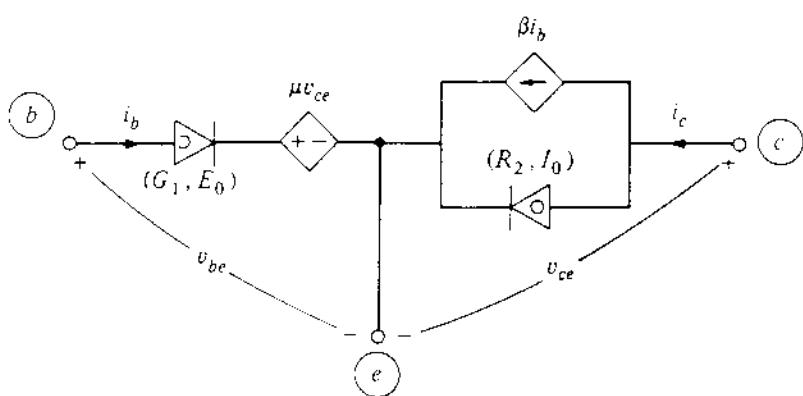


(b)

Characteristic of common-emitter configuration of an *n-p-n* transistor.



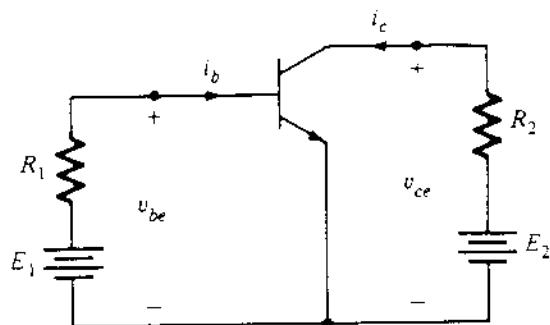
Piecewise-linear approximation of the common-emitter characteristics.



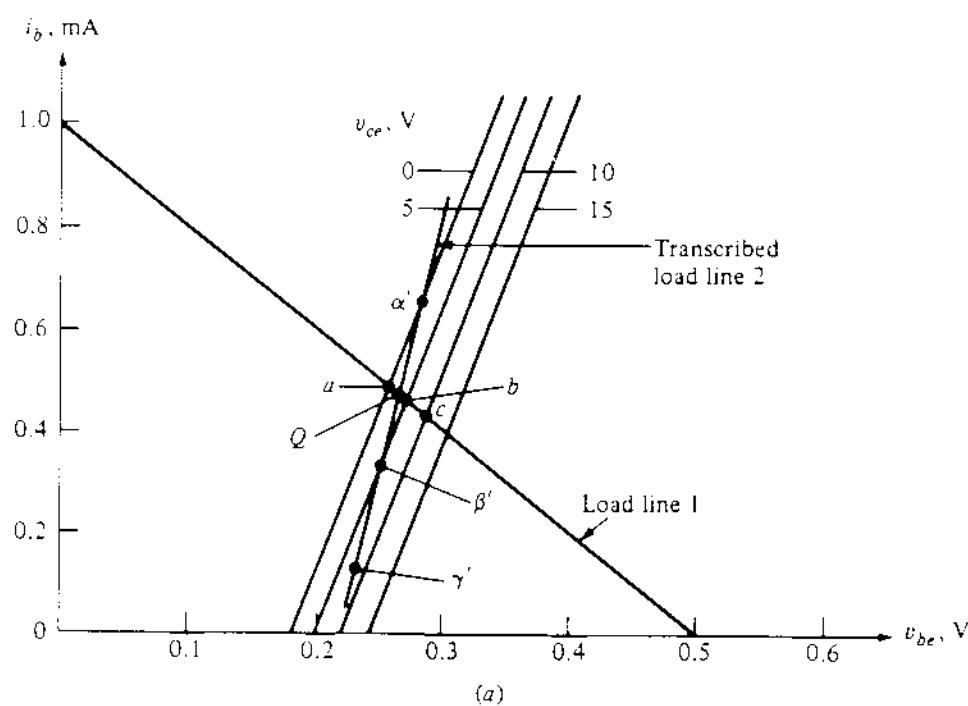
Piecewise-linear model of common-emitter transistor configuration.

DC Σημεία Λειτουργίας & Γραμμές Φορτίου (για Transistor)

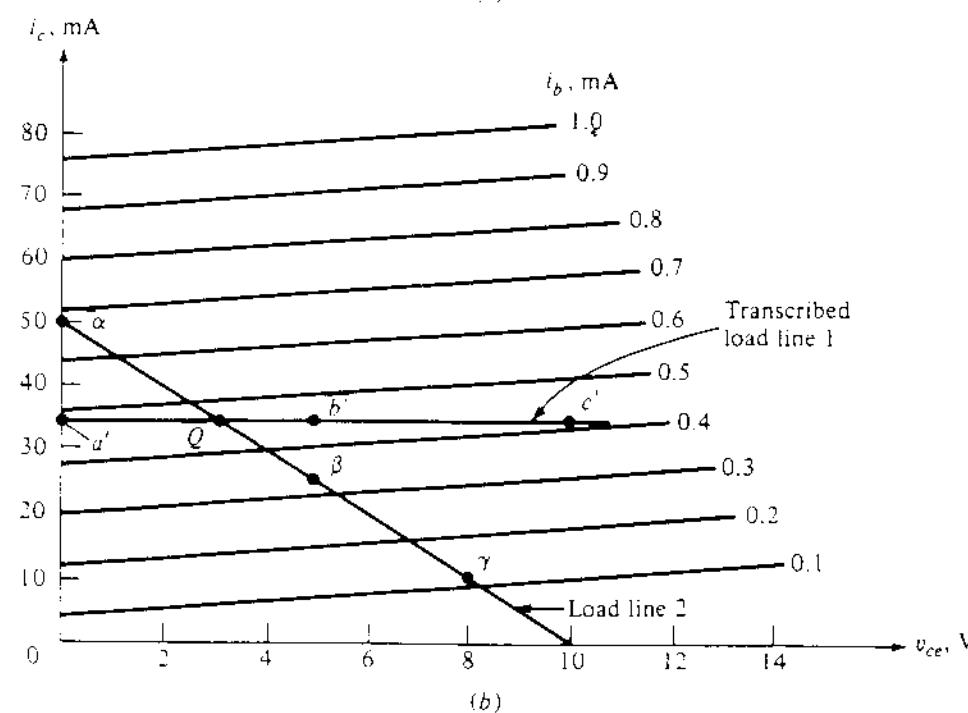
- Κύκλωμα πόλωσης (biasing circuit)



- Εύρεση σημείου λειτουργίας με γραφική μέθοδο.



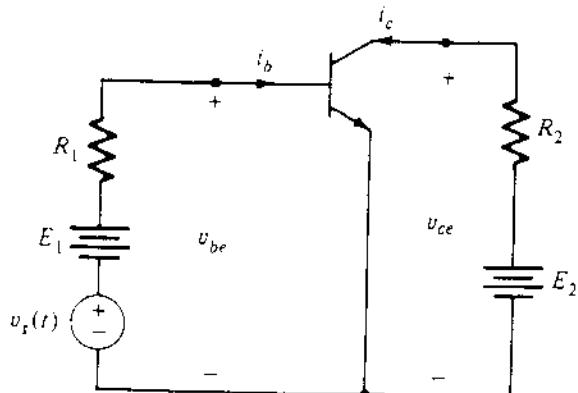
(a)



(b)

Ανάλυση Μικρού Σήματος (για Transistor)

- Transistor Amplifier



- Υλριδικό Μοντέλο

$$V_{be} = \hat{V}_{be}(i_b, V_{ce}), \quad \hat{i}_c = \hat{I}_c(i_b, V_{ce})$$

$$V_{beQ} = \hat{V}_{be}(I_{bQ}, V_{ceQ})$$

$$I_{cQ} = \hat{I}_c(I_{bQ}, V_{ceQ})$$

$$V_{beQ} = E_1 - R_1 I_{bQ}$$

$$V_{ceQ} = E_2 - R_2 I_{cQ}$$

DC ανάχυση

$$v_{be}(t) = V_{beQ} + \tilde{v}_1(t)$$

$$i_b(t) = I_{bQ} + \tilde{i}_1(t)$$

$$v_{ce}(t) = V_{ceQ} + \tilde{v}_2(t)$$

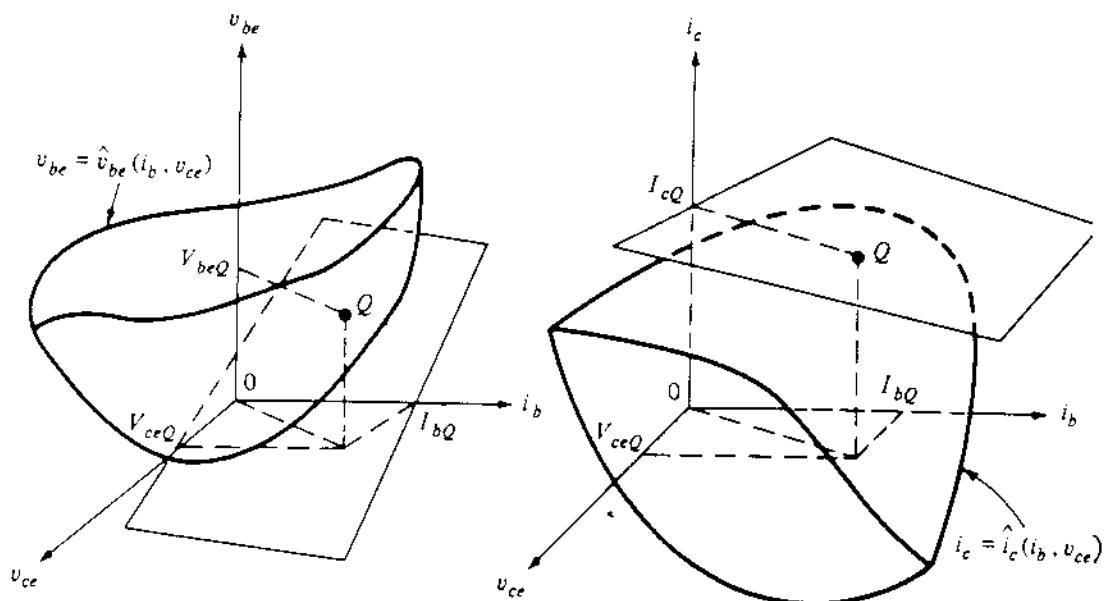
$$i_c(t) = I_{cQ} + \tilde{i}_2(t)$$

Perturbation

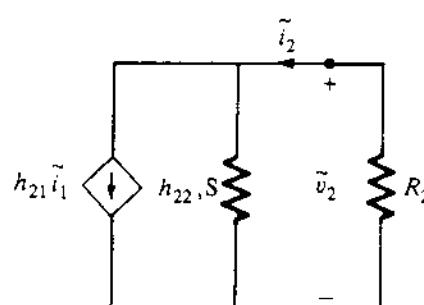
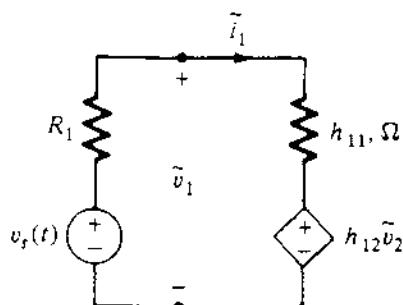
- Avantuvjn twn V_{be} kai i_c se eipres Taylor gypw anio (I_{bQ}, V_{ceQ})

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \tilde{V}_1(t) \\ \tilde{I}_2(t) \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} \tilde{i}_1(t) \\ \tilde{V}_2(t) \end{bmatrix}, \quad H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \hat{V}_{be}}{\partial i_b} & \frac{\partial \hat{V}_{be}}{\partial V_{ce}} \\ \frac{\partial \hat{I}_c}{\partial i_b} & \frac{\partial \hat{I}_c}{\partial V_{ce}} \end{bmatrix} \Big|_Q \quad \begin{cases} \text{Υλριδικός} \\ \text{πίνακας} \\ \text{μικρού} \\ \text{σήματος} \end{cases}$$

- Γεωμετρική Εφαννεία



- Ισοδύναμο κύκλωμα μικρού σήματος



Small-signal equivalent circuit of the amplifier.

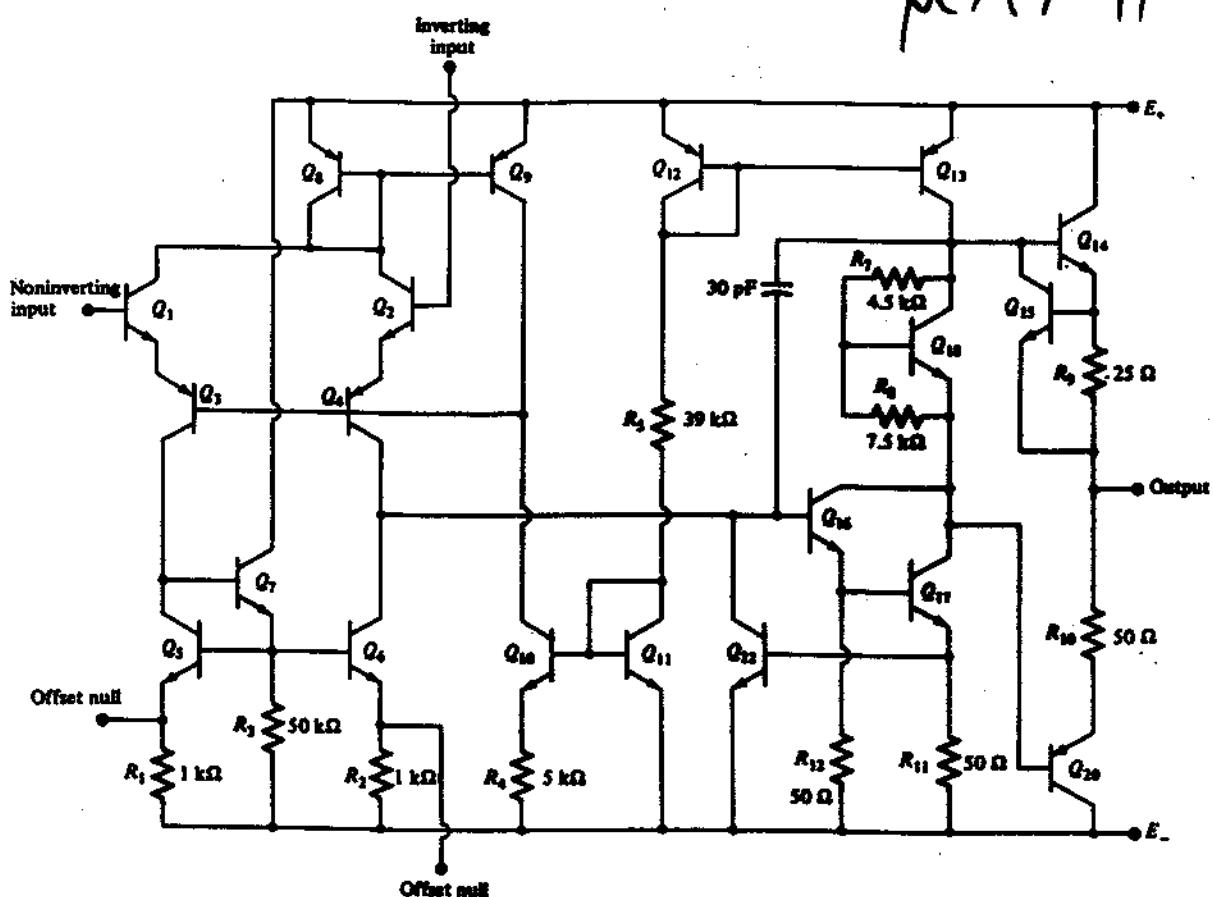


Figure 1.3 Schematic of the μ A741 op amp.

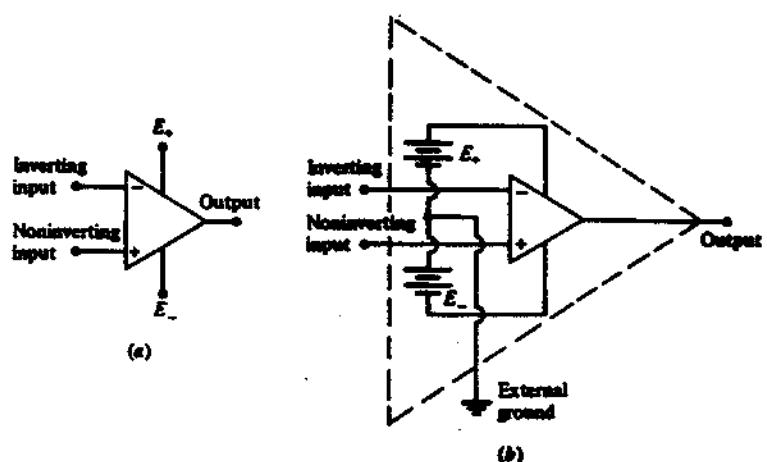


Figure 1.4 Standard op-amp symbol and a typical biasing scheme. (a) The - and + signs inside the triangle denote the inverting and noninverting input terminals, respectively. (b) A "biased" op amp (enclosed within the triangle) can be considered as a 4-terminal device for circuit analysis and design purposes.

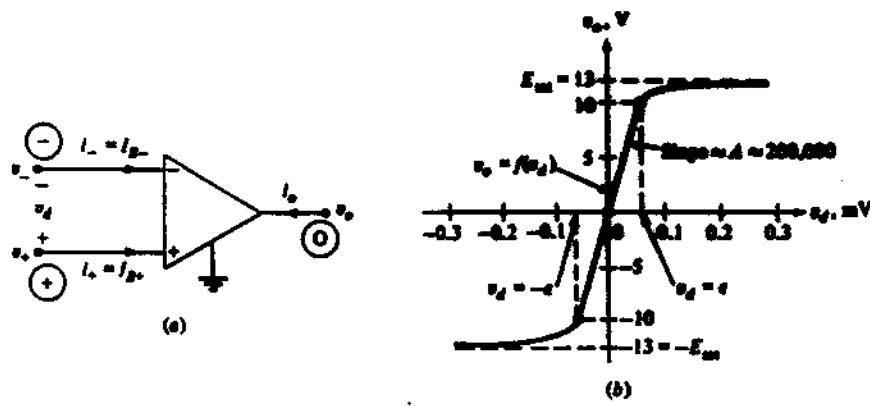


Figure 1.5 Experimental characterization of a typical op amp.

μA741 Data

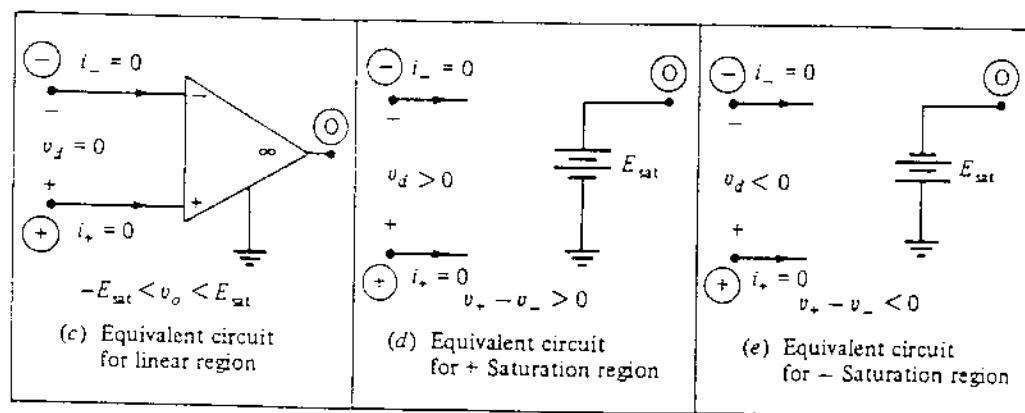
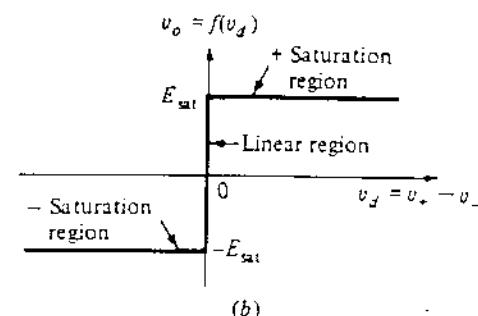
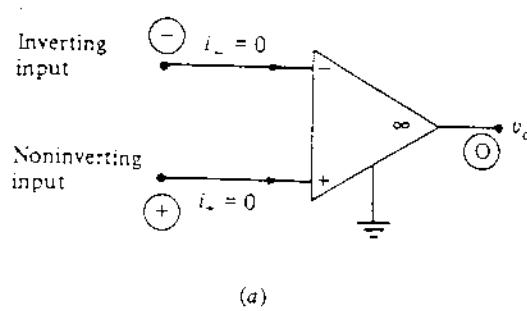
$E_+ = 15V, E_- = -15V$.

Input Bias Current = $\frac{|I_{B+}| + |I_{B-}|}{2} = 80\text{nA}$.

Offset Current = $|I_{B+}| - |I_{B-}| = 20\text{nA}$.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ (Chua, Desoer & Kuh, 1987)

* Απειρού Κέρδος: $A = \infty$

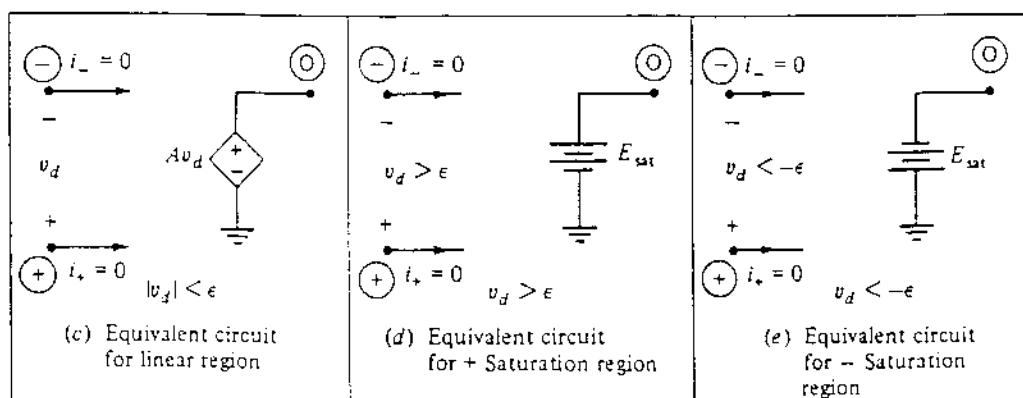
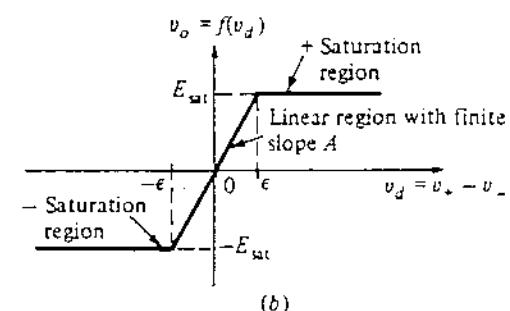
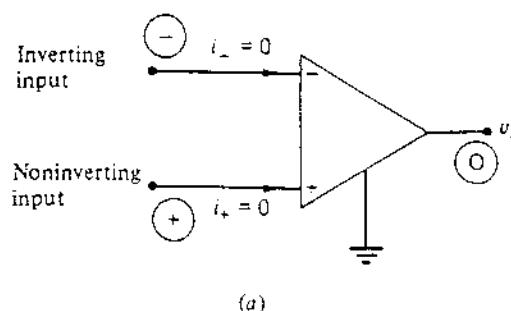


Ideal op-amp model.

* Τεπεραγμένο Κέρδος: $A < \infty$

Finite-gain op-amp model

$$\begin{aligned} i_- &= 0 \\ i_+ &= 0 \\ v_o &= f(v_d) \triangleq \frac{A}{2} |v_d + \epsilon| - \frac{A}{2} |v_d - \epsilon| \end{aligned}$$



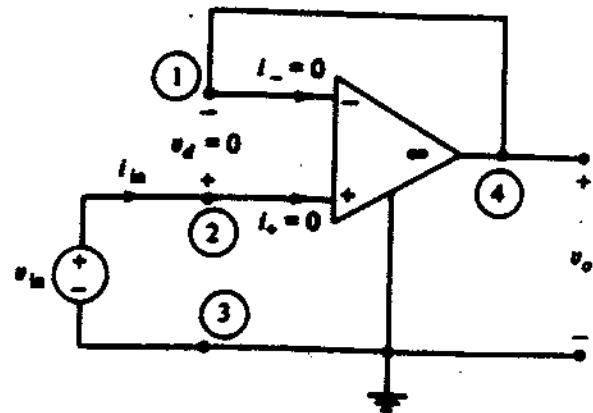
Finite-gain op-amp model.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΛΕΣΤ. ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
 $(i_- = 0, i_+ = 0, v_d = v_+ - v_- = 0, -E_{sat} < v_o < E_{sat})$

Ακολουθητής Τάσης (voltage follower, buffer):

$$v_o = v_{in}$$

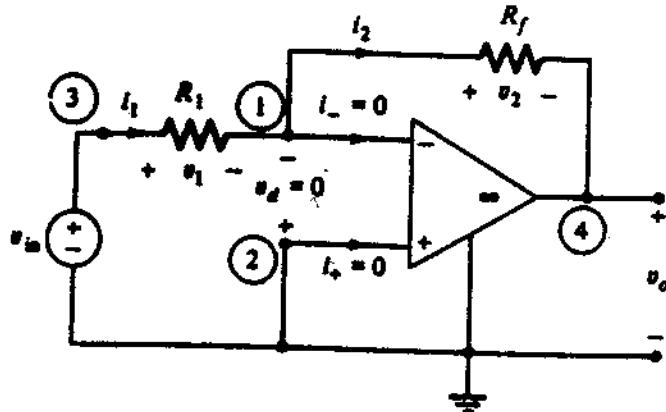
$$-E_{sat} < v_{in} < E_{sat}$$



Αντιστρέφων Ενισχυτής (inverting amplifier):

$$v_o = -(R_f/R_1)v_{in}$$

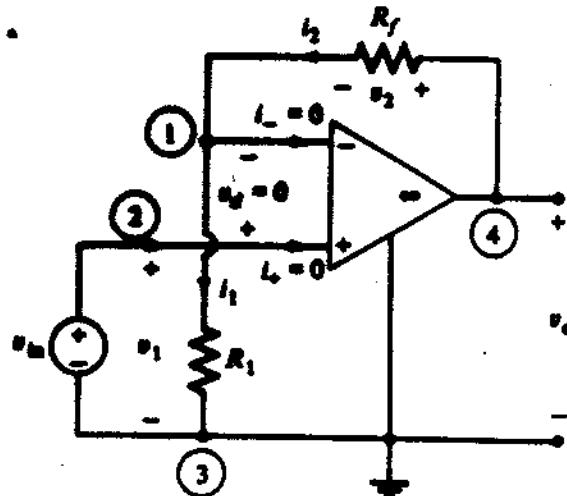
$$-\frac{R_1}{R_f}E_{sat} < v_{in} < \frac{R_1}{R_f}E_{sat}$$



Μη-Αντιστρέφων Ενισχυτής (non-inverting amplifier):

$$v_o = (1 + R_f/R_1)v_{in}$$

$$-\frac{R_1E_{sat}}{R_1 + R_f} < v_{in} < \frac{R_1E_{sat}}{R_1 + R_f}$$



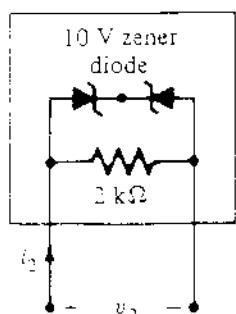
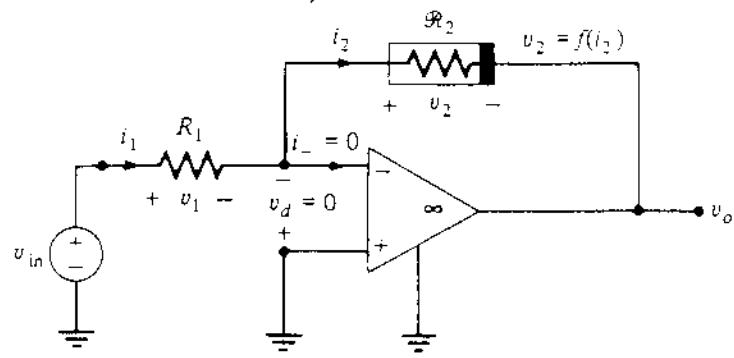
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΛΕΣΤ. ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

($i_- = 0, i_+ = 0, v_d = v_+ - v_- = 0, -E_{\text{sat}} < v_o < E_{\text{sat}}$)

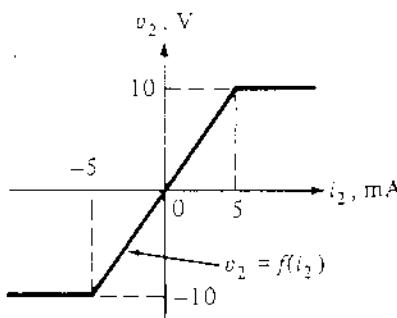
Μη-γραμμική Ανάδραση (nonlinear feedback):

$$v_o = -f \left(\frac{v_{\text{in}}}{R_1} \right)$$

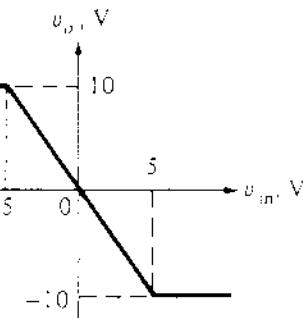
$$-E_{\text{sat}} < f \left(\frac{v_{\text{in}}}{R_1} \right) < E_{\text{sat}}$$



(a)



(b)



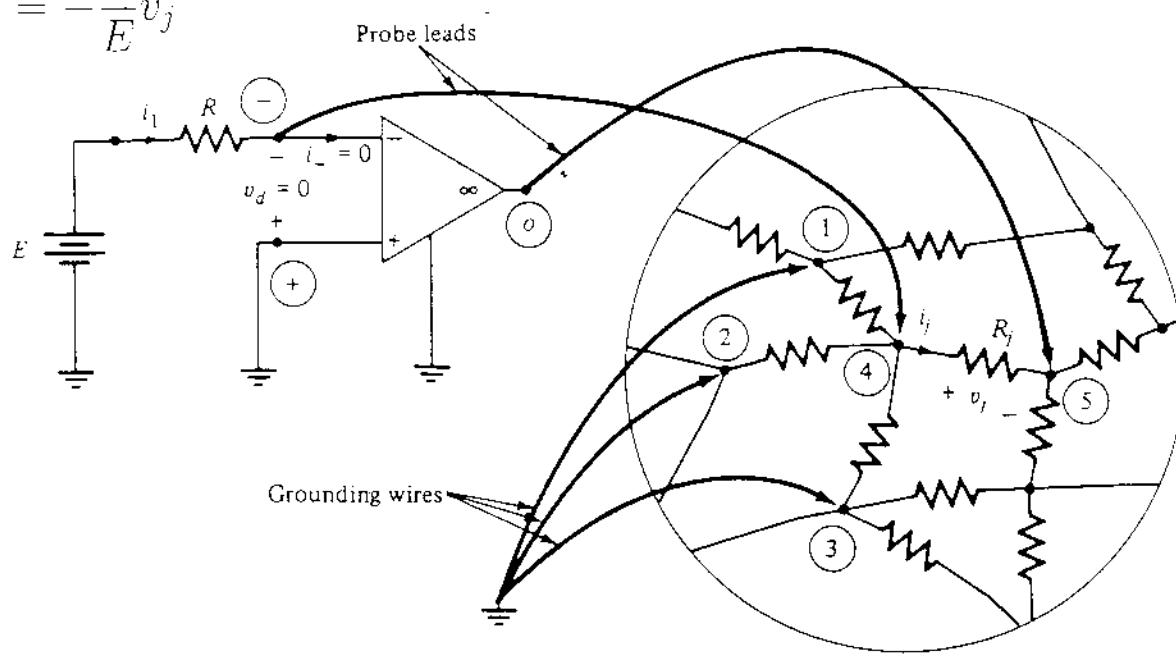
(c)

(a) Circuit for realizing the nonlinear resistor \mathcal{R}_2 characteristic of the circuit in a. (c) Transfer characteristic of the circuit replaced by the circuit in a, and assuming $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$.

(b) Driving-point with \mathcal{R}_2

Μέτρηση αντίστασης χωρίς αποσύνδεση (ανιχνευτής σφάλματος):

$$R_j = -\frac{R}{E} v_j$$

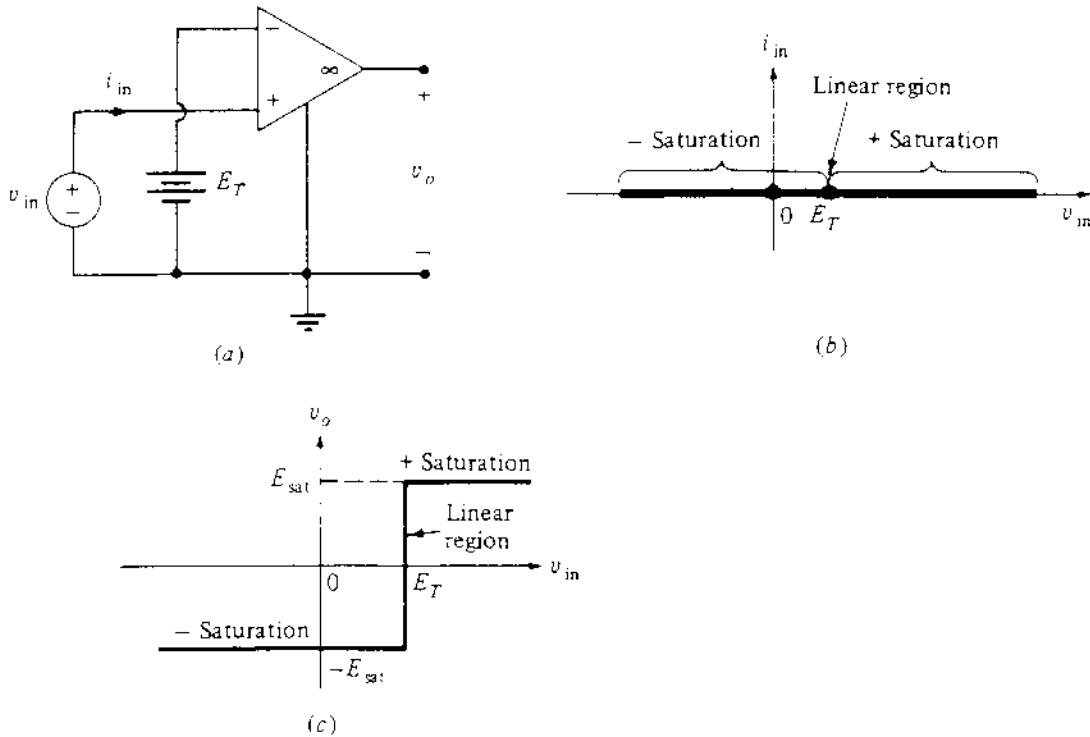


op-amp fault detector.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΛΕΣΤ. ΕΝΙΣΧ. ΣΤΗΝ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

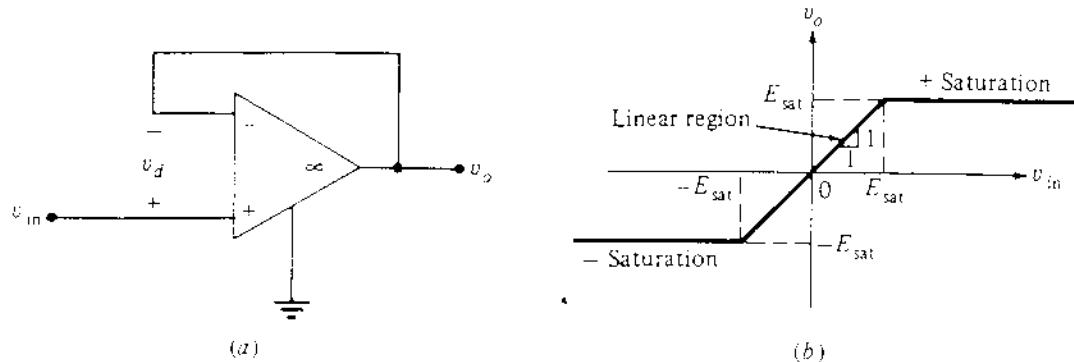
($i_- = 0$, $i_+ = 0$, $v_o = E_{sat}\text{sign}(v_d)$, $v_d = v_+ - v_- \neq 0$)

Συγκριτής, Ανιχνευτής Κατωφλίου (Comparator, Threshold Detector):

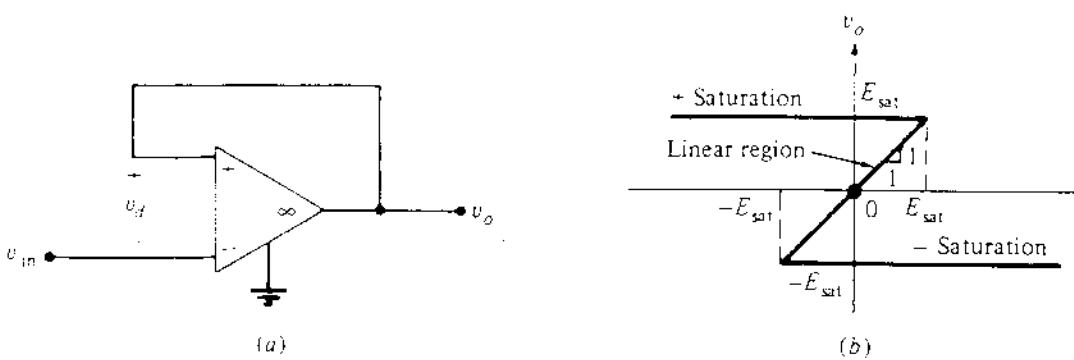


(a) Comparator. (b) Driving-point characteristic. (c) Transfer characteristic.

Κύκλωμα αρνητικής και θετικής ανάδρασης:



(a) A negative feedback circuit and (b) its transfer characteristic.

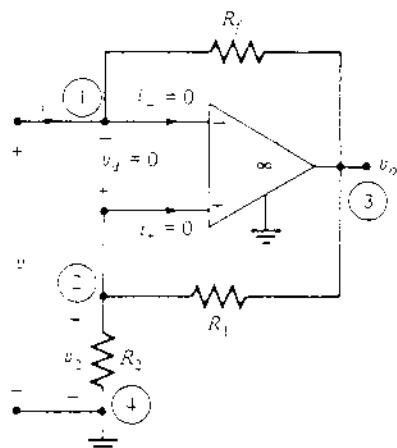
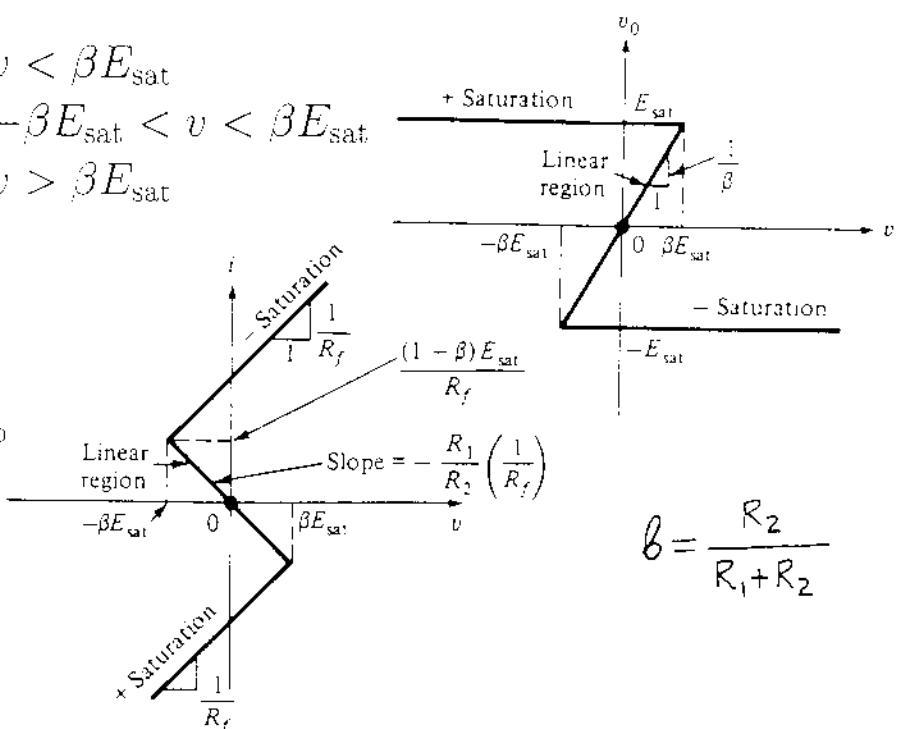
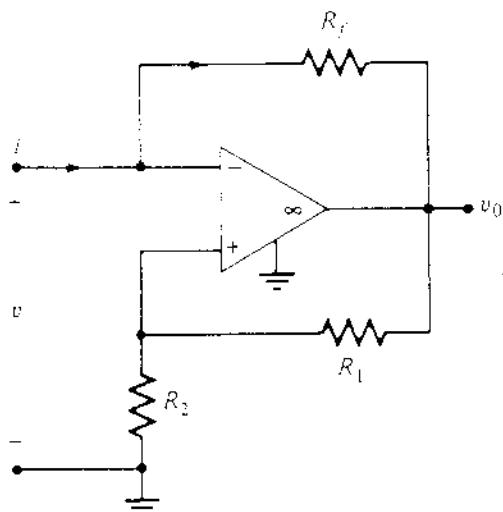


(a) A positive feedback circuit and (b) its transfer characteristic.

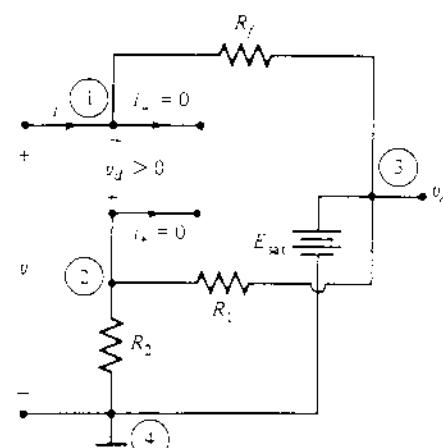
ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:

Μετατροπέας αρνητικής αντίστασης (negative-resistance converter)

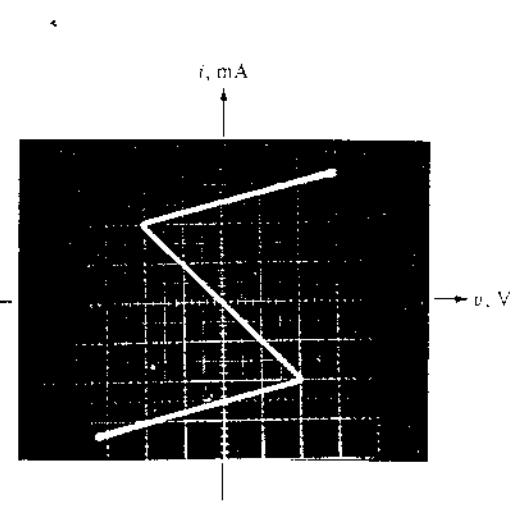
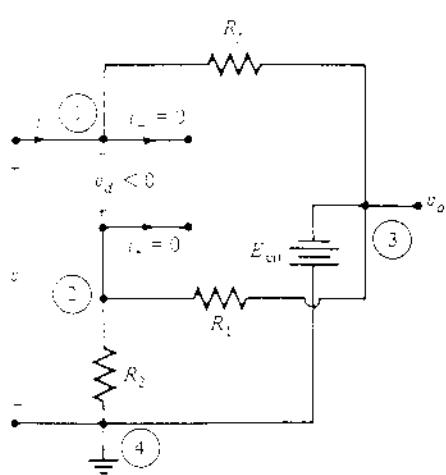
$$v_o = \begin{cases} R_f i + E_{\text{sat}}, & v < \beta E_{\text{sat}} \\ -(R_2 R_f / R_1) i, & -\beta E_{\text{sat}} < v < \beta E_{\text{sat}} \\ R_f i - E_{\text{sat}}, & v > \beta E_{\text{sat}} \end{cases}$$



(a)



(b)



Equivalent circuit in (a) linear region, (b) + Saturation region, (c) - Saturation region, and (d) typical negative-resistance characteristic measured from an actual op-amp circuit.

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:

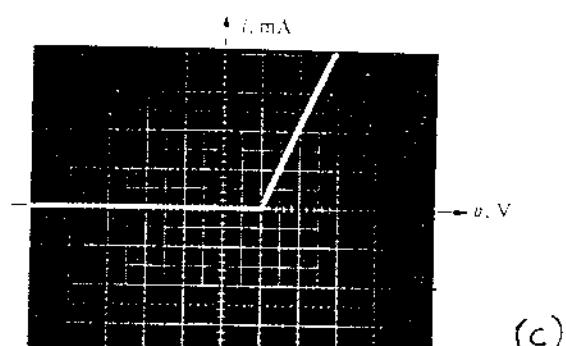
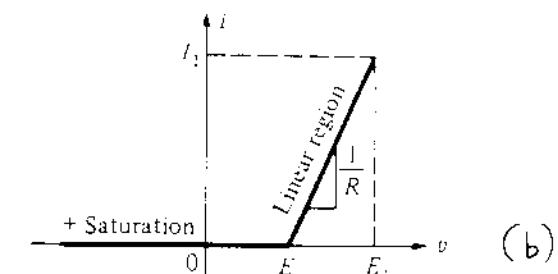
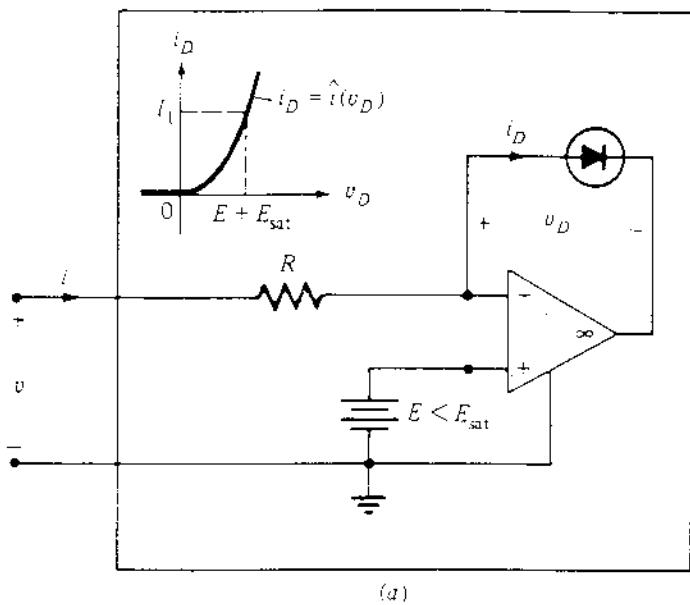
Κοίλος Αντιστάτης (concave resistor)

$$i = \begin{cases} 0, & v < E \\ \frac{1}{R}(v - E), & E < v < E_1 \\ i_D = \hat{i}(v_D), & v > E_1 \end{cases}$$

$$\hat{i}(v_D) = \begin{cases} I_s(e^{v_D/v_T} - 1), & v_D \geq 0 \\ 0, & v_D < 0 \end{cases}$$

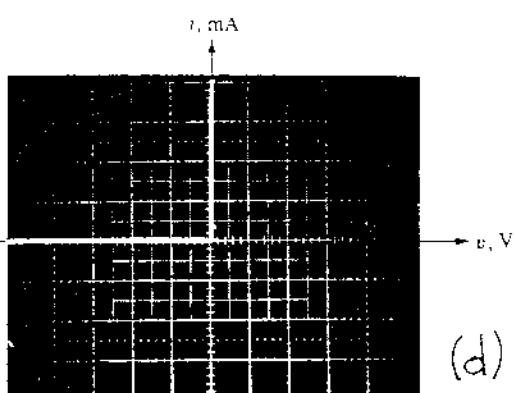
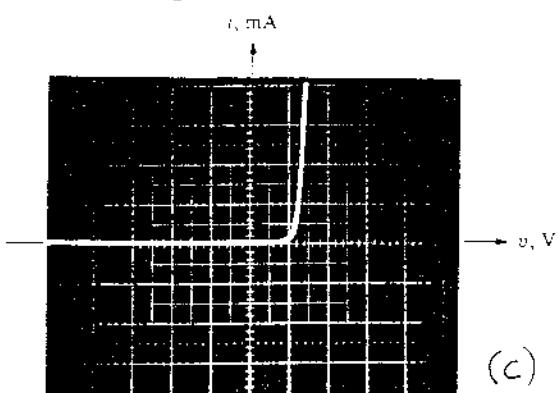
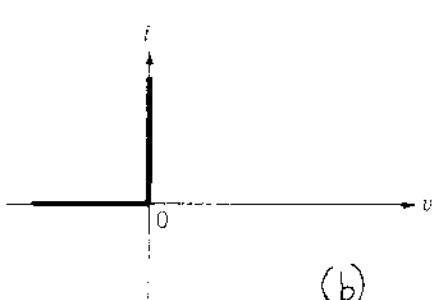
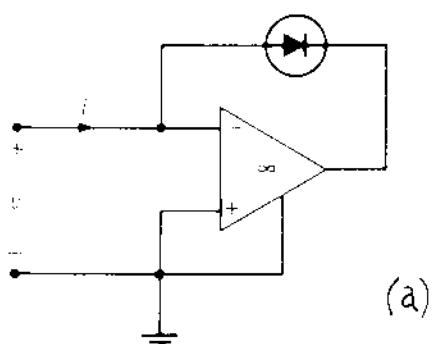
$$I_1 = \hat{i}(E + E_{sat})$$

$$E_1 = E + RI_1$$



(a) Practical realization of a nearly ideal concave resistor characteristic. (b) Predicted characteristic for $v < E_1$, where $E_1 \triangleq E + R\hat{i}(E - E_{sat})$, provided $E < E_{sat}$. (c) Measured characteristic.

$R \rightarrow 0, E \rightarrow 0 \Rightarrow$ Ιδανική Διόδος



(a) Op-amp circuit realization of an ideal diode. (b) Limiting characteristic when $R \rightarrow 0$ and $E \rightarrow 0$. (c) Characteristic of the pn -junction diode in the op-amp circuit. (d) Measured driving-point characteristic.

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙ-ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ (ΜΟΝΟΘΥΡΑ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- **Αντιστάτης** = στοιχείο που η τάση v και το ρεύμα i ικανοποιούν την σχέση ($v - i$ χαρακτηριστική)

$$\mathcal{R}_{res} = \{(v, i) : f_R(v, i, t) = 0\}$$

- **Πυκνωτής** = στοιχείο που το φορτίο q και η τάση v ικανοποιούν την σχέση ($q - v$ χαρακτηριστική)

$$\mathcal{R}_{cap} = \{(q, v) : f_C(q, v, t) = 0\}$$

- **Επαγωγέας** = στοιχείο που η ροή ϕ και το ρεύμα i ικανοποιούν την σχέση ($\phi - i$ χαρακτηριστική)

$$\mathcal{R}_{ind} = \{(\phi, i) : f_L(\phi, i, t) = 0\}$$

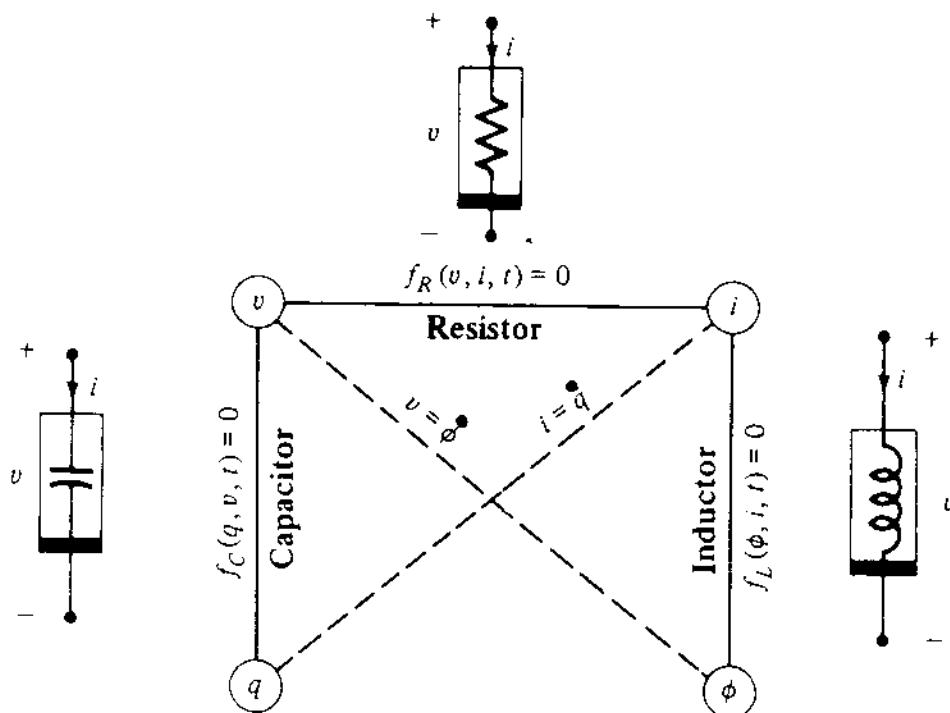
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Χρονικά-Αμετάβλητο $\iff \mathcal{R}$ δεν αλλάζει με τον χρόνο

Χρονικά-Μεταβαλλόμενο $\iff \mathcal{R}$ αλλάζει με τον χρόνο

Γραμμικό $\iff f(x, y, t) = ax + by$

Μη-γραμμικό $\iff f(x, y, t) \neq ax + by$



ΜΟΝΟΘΥΡΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ (Capacitor)

ονομάζεται ένα στοιχείο του οποίου το **φορτίο** $q(t) = \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau$ και η **τάση** $v(t)$ εκανοποιούν την σχέση ($q = v$ χαρακτηριστική)

$$\mathcal{R}_{cap} = \{(q, v) : f(q, v) = 0\}$$

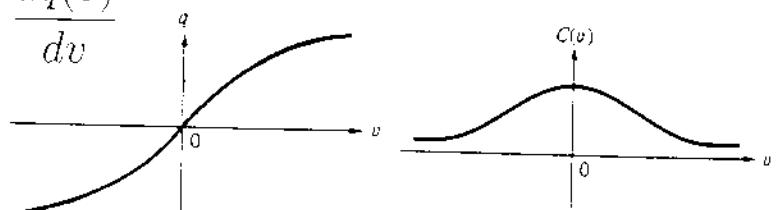
q -ελεγχόμενος (charge-controlled): $f(q, v) = 0 \Rightarrow v = \dot{v}(q)$

v -ελεγχόμενος (voltage-controlled): $f(q, v) = 0 \Rightarrow q = \dot{q}(v)$

Χωρητικότητα αδύνατου σήματος (χρον.-αμετ. & v -ελεγχόμ. πυκνωτή)

small-signal capacitance: $C(v) = \frac{d\dot{q}(v)}{dv}$

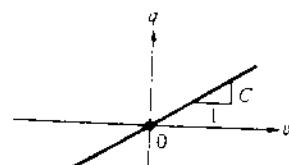
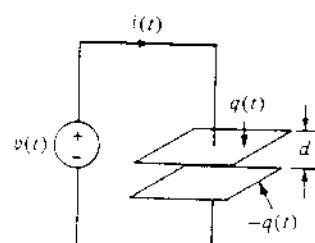
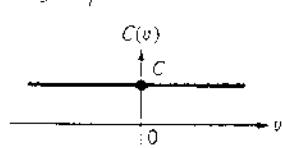
$$i(t) = C(v) \frac{dv(t)}{dt}$$



Γραμμικός Χρονικά-Αμετάβλητος: $q(t) = Cv(t)$, $i(t) = Cdv/dt$

parallel-plate capacitor

$$C = \epsilon_0 A/d$$



Μη-γραμμικός Χρονικά-Αμετάβλητος: (Varactor diode)

$$q = \hat{q}(v) = -K \sqrt{V_0 - v(t)}$$

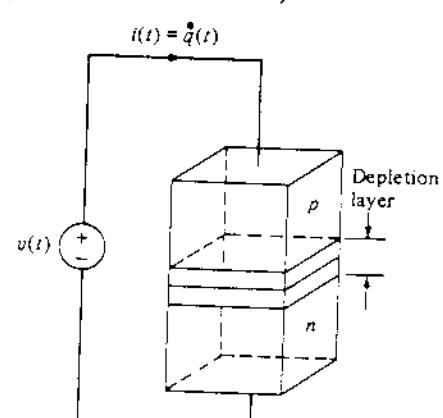
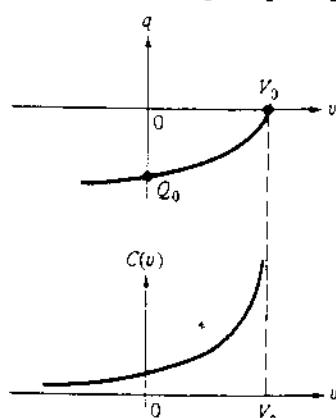
$$C(v) = K/2\sqrt{V_0 - v}$$

$$K = 2\epsilon N_a N_d A / (N_a + N_d)$$

N_a = acceptor atom density

N_d = donor atom density

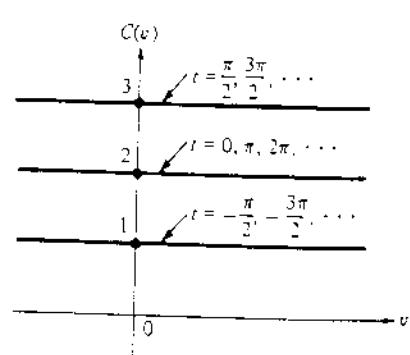
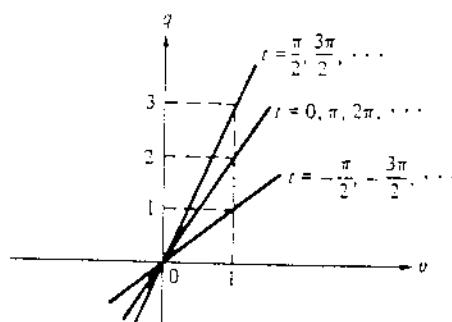
A = cross-sectional area



Γραμμικός Χρονικά-Μεταβαλλόμενος: $q(t) = C(t)v(t)$

$$i(t) = C(t) \frac{dv(t)}{dt} + \frac{dC(t)}{dt} v(t)$$

$$C(t) = 2 + \sin(t)$$



ΜΟΝΟΘΥΡΟΣ ΕΠΑΓΩΓΕΑΣ (Inductor)

ονομάζεται ένα στοιχείο του οποίου η **ροή** $\phi(t) = \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau$ και το **ρεύμα** $i(t)$ ικανοποιούν την σχέση ($\phi - i$ χαρακτηριστική)

$$\mathcal{R}_{ind} = \{(\phi, i) : f(\phi, i) = 0\}$$

ϕ -ελεγχόμενος (flux-controlled): $f(\phi, i) = 0 \Rightarrow i = \hat{i}(\phi)$

i -ελεγχόμενος (current-controlled): $f(\phi, i) = 0 \Rightarrow \phi = \hat{\phi}(i)$

Επαγωγή αδύνατου σήματος (χρον.-αμετ. & i -ελεγχόμενο στοιχείο)

small-signal inductance: $L(i) = \frac{d\phi(i)}{di} \Rightarrow v(t) = L(i) \frac{di(t)}{dt}$

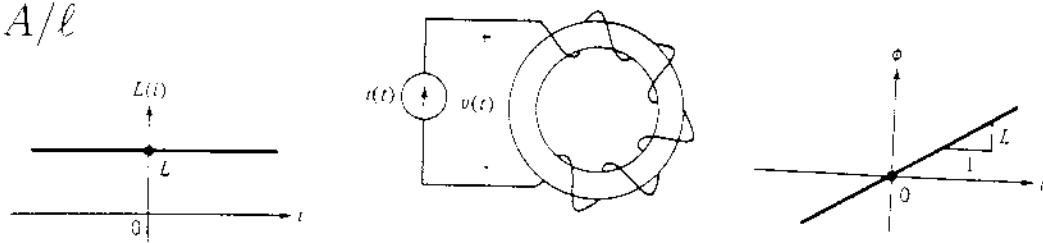
Αντίστροφη Επαγωγή αδύνατου σήματος (ϕ -ελεγχόμενο στοιχείο)

reciprocal small-signal inductance: $\Gamma(\phi) = \frac{d\hat{i}(\phi)}{d\phi}$

Γραμμικός Χρονικά-Αμετάβλητος: $\phi(t) = Li(t)$, $v(t) = Ldi/dt$

toroidal inductor

$$L = \mu_0 N^2 A / \ell$$



Μη-γραμμικός Χρονικά-Αμετάβλητος: (Josephson junction)

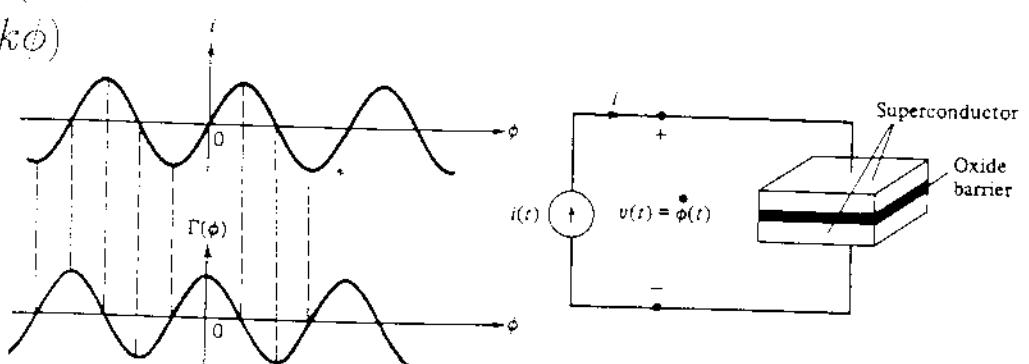
$$i = \hat{i}(\phi) = I_0 \sin(k\phi)$$

$$\Gamma(\phi) = kI_0 \cos(k\phi)$$

$$k = 4\pi e/h$$

e = electron charge

h = Planck's constant

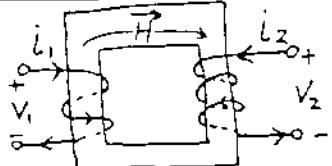


Γραμμικός Χρονικά-Μεταβαλλόμενος: $\phi(t) = L(t)i(t)$

$$v(t) = \frac{d\phi(t)}{dt} = L(t) \frac{di(t)}{dt} + \frac{dL(t)}{dt} i(t)$$

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

(Συζευγμένοι Επαγγωγείς - Coupled Inductors)



$$\text{Γ.Χ.Α.} \rightarrow \varphi_1 = L_1 i_1 + M_{12} i_2 \quad \varphi_2 = M_{21} i_1 + L_2 i_2 \Rightarrow \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M_{12} \\ M_{21} & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} di_1/dt \\ di_2/dt \end{bmatrix} = \underline{L} \text{ (πινακας επαγγωγής)}$$

inductance matrix

αυτεπαγγώγεις (self-inductance): L_1, L_2

αλληλεπαγγώγη (mutual inductance): $M = M_{12} = M_{21}$

Αποθηκευτική Μαγνητική Ενέργεια:

$$E_M(i_1, i_2) = \frac{1}{2} (L_1 i_1^2 + 2M i_1 i_2 + L_2 i_2^2) = \frac{1}{2} [i_1 \ i_2] \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$E_M > 0 \quad \forall i_1 \neq 0, i_2 \neq 0 \Leftrightarrow L = \text{θετικά ορισμένος πιν.} \Leftrightarrow L_1, L_2 > 0, M^2 < L_1 L_2$$

Συντελεστής Ζεύγης (coupling coefficient): $K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}, |K| \leq 1$

$K=0 \rightarrow$ δεν υπάρχει μαγνητική σύγεγύη

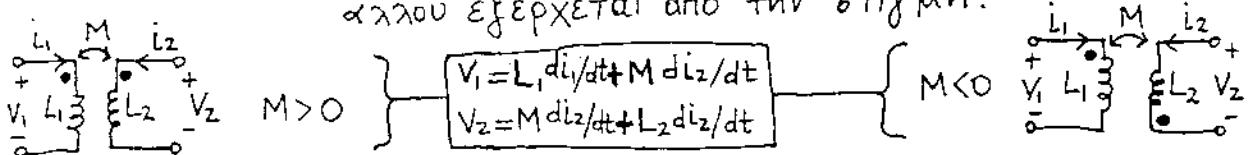
$$|K|=1 \quad \boxed{\text{Tέλειος μετ/στής}} \Rightarrow \frac{L_1}{M} = \frac{M}{L_2} = \frac{V_1}{V_2}, \exists i_1 \neq 0, i_2 \neq 0 \text{ και } E_M = 0$$

Πρόσημο του M , $M = |M| \text{sign}(M)$:

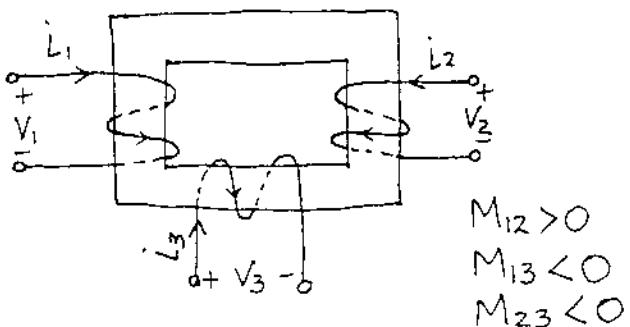
$\text{sign}(M) = \begin{cases} +1, & \text{εάν οι δικτύα } i_1, i_2 \text{ παράγουν μαγν. ροή ίδιας φοράς} \\ -1, & \text{" " " " " " " " " αντίθετης "} \end{cases}$

Συμβολισμός Στιγμών: Τύπος ανοργής προβεκτικής σχεδίασης της φοράς περιέλιψης πινιών, τοποθετούνται στιγμές σε ένα ακρό κάθε πινιού ώστε εισερχόμενα θετικά ρεύματα να παράγουν αλληλενισχύομενες μαγν. ροές. Αφού τοποθετηθούν οι στιγμές και επιλέχθούν οι φορές αναφοράς ρευμάτων, οι στιγμές έξερχονται από την στιγμή.

$$\text{sign}(M) = \begin{cases} +1, & \text{εάν οι φορές αναφοράς των ρευμάτων εισέρχονται στη στιγμή.} \\ -1, & \text{εάν η φορά αναφοράς ενός ρευμάτου εισέρχεται στην στιγμή.} \end{cases}$$



3 Συζευγμένα Τηνία



$$\begin{aligned} M_{12} > 0 \\ M_{13} < 0 \\ M_{23} < 0 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} V_1(t) \\ V_2(t) \\ V_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 & M_{12} & M_{13} \\ M_{12} & L_2 & M_{23} \\ M_{13} & M_{23} & L_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} di_1/dt \\ di_2/dt \\ di_3/dt \end{bmatrix}$$